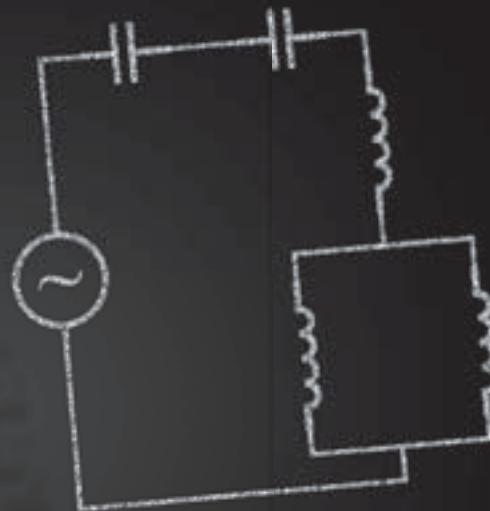


## فصل پنجم



**هرتز**

ولتاژ مانکریم  
Inductance

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L/C}}$$

**خازن Admittance**

اندوگتانس توان غیر موثر  
Impedance

ضریب خودالقایق میکروفاراد (زیانس)

$$\text{جریان} \times \text{ مقاومت} = \text{ ولتاژ}$$

راکتانس اثناهای مذکور (زن) حالت تشديد  
بردار

**SUSCEPTANCE** منبع ولتاژ

$$\theta_v = 30^\circ$$

لوازان ظاهری

$$I_{(t)} = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

خاصیت سلفی

امیدانس در حالت روزنامه

**راکتانس** ولتاژ موثر منبع

$$P_S = V_e I_e$$

**Resistance**

$$X_L = X_C$$

وار

دستگاه های هم باری

توان غیر موثر

توان هر بردار

**اکتیو** مقاومت های سلفی و خازنی

$$Reactance X_L = \omega L = 5000 \times 5 \times 10^{-7} = 2.5 \Omega$$

اندوگتانس سلفی ولتاژ مانکریم

**مدارهای LC سری و موازی** Serial LC Circuits

فرکانس صفر مینا منبع خازن

$$X_L = 7 \pi f L$$

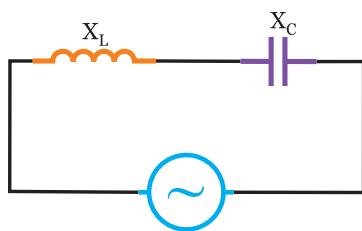
برای متری توان دو اندام

$$P_d = P_{dc} + P_{dl}$$

امیدانس میکروفاراد

Capacitance

در مدارهای LC سری مطابق شکل (۵-۴) اختلاف فاز  $\varphi = 90^\circ$  می‌باشد.

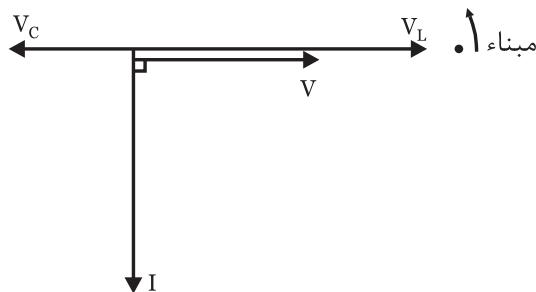


شکل (۵-۴)

$$V_{(t)} = V_m \sin \omega t$$

$$i_{(t)} = I_m \sin(\omega t \pm 90^\circ)$$

اگر  $X_L > X_C$  باشد. مراحل ایجاد نمودار شکل (۵-۵) به صورت زیر حاصل می‌شود.



شکل (۵-۵)

- مبدأ را ترسیم کنید.
- بردار  $V$  را رسم کنید.
- جریان منبع از ولتاژ منبع  $90^\circ$  درجه عقبتر است.
- معادله زمانی جریان منبع به صورت

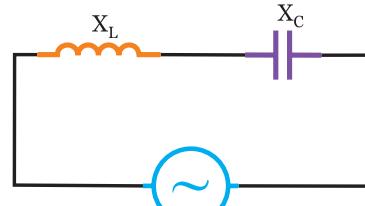
$$i_{(t)} = I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

نوشته می‌شود.

- در سلف جریان  $90^\circ$  از ولتاژ دو سرش عقبتر است لذا  $V_L$  نسبت به  $I$ ,  $90^\circ$  جلوتر ترسیم می‌شود. از آنجاییکه مدار پس فاز است لذا  $V_L > V_C$  می‌باشد.
- در خازن جریان  $90^\circ$  از ولتاژ دو سرش جلوتر است لذا  $V_C$  نسبت به  $I$ ,  $90^\circ$  عقبتر ترسیم می‌شود. از آنجاییکه مدار پیش فاز است لذا  $V_L < V_C$  می‌باشد.

### ۵-۱-۱- مدارهای LC سری:

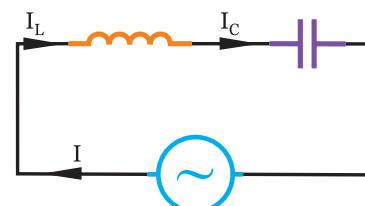
هرگاه یک مقاومت سلفی و یک مقاومت خازنی بصورت سری به یک منبع ولتاژ متناوب متصل شود. مطابق شکل (۵-۱) مدار LC سری را تشکیل می‌دهد.



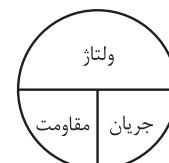
شکل (۵-۱)

$$Z = |X_L - X_C|$$

در مدارهای LC سری جریان منبع با جریان هر یک از عناصر که در شکل (۵-۲) دیده می‌شود برابر می‌باشد.



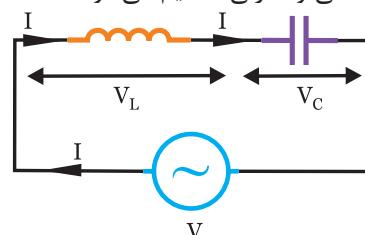
شکل (۵-۲)



$$\frac{\text{ولتاژ}}{\text{مقاومت}} = \frac{\text{جریان}}{\text{سلفی}}$$

$$I = \frac{V}{Z} \quad I_L = I_c = I$$

در این مدارها در شکل (۵-۳) ولتاژ منبع به نسبت مقاومت‌های سلفی و خازنی تقسیم می‌شود.



شکل (۵-۳)

$$V = |V_L - V_C|$$

$$V_L = X_L I \quad , \quad V_C = X_C I$$

برای بدست آوردن توان در مدارهای LC سری به علت اینکه  $\phi = \pm 90^\circ$  است، داریم.

$$\phi = \pm 90^\circ \Rightarrow \cos\phi = 0, \sin\phi = \pm 1$$

- توان موثر یا مصرفی صفر می‌باشد.

$$P_e = V_e I_e \cdot \cos\phi = 0$$

- توان غیر موثر یا راکتیو می‌شود.

$$P_d = V_e I_e \cdot \sin\phi = \pm V_e I_e$$

اگر  $X_L > X_C$  باشد مدار پس فاز بوده و  $P_d = V_e I_e$  می‌شود

و اگر  $X_L < X_C$  باشد مدار پیش فاز بوده و  $P_d = -V_e I_e$  می‌شود.

- توان ظاهری می‌شود.

$$P_s = V_e I_e \Rightarrow P_s = |P_d|$$

## ۲-۵- تاثیر فرکانس بر روی امپدانس و

### جريان در مدار LC سری:

از آنجائیکه با افزایش فرکانس مقاومت سلفی

$$X_L = \frac{1}{2\pi f L}$$

افزایش می‌یابد و با افزایش فرکانس مقاومت خازنی

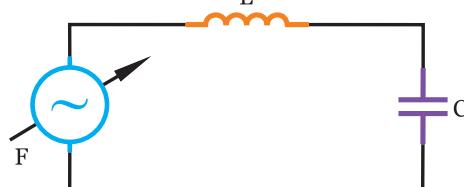
$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

کاهش می‌یابد، لذا با توجه به فرمول‌های  $|X_L - X_C| = Z$  و

$$I = \frac{V}{Z}$$

در شکل‌های زیر، Z و I در کمترین و بیشترین فرکانس

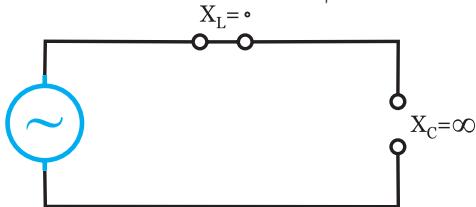
و فرکانس رزنانس بررسی می‌کنیم.



شکل (۵-۸)

که سه حالت اتفاق می‌افتد.

(۱) فرکانس صفر (DC):



شکل (۵-۹)

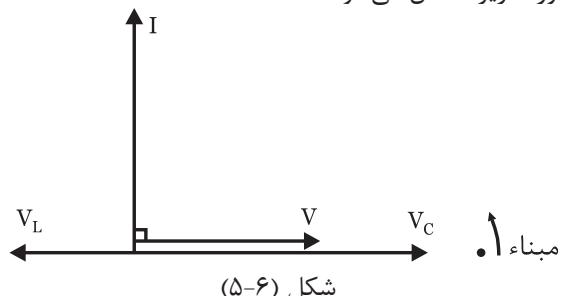
$$X_L = 0$$

$$X_C = \infty$$

$$Z = \infty$$

$$I = 0$$

اگر  $X_L < X_C$  باشد. مراحل ایجاد نمودار شکل (۵-۶) به صورت زیر حاصل می‌شود.



شکل (۵-۶)

- مبدأ را ترسیم کنید.

- بردار V را رسم کنید.

- جریان منبع از ولتاژ منبع  $90^\circ$  جلوتر است.

- معادله زمانی جریان منبع به صورت

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

نوشته می‌شود.

- در سلف جریان  $90^\circ$  از ولتاژ دو سرش عقب‌تر است لذا  $V_L$  نسبت به  $I$ ،  $90^\circ$  جلوتر ترسیم می‌شود. از آنجائیکه مدار

پیش فاز است لذا  $V_L < V_C$  می‌باشد.

- در خازن جریان  $90^\circ$  از ولتاژ دو سرش جلوتر است لذا  $V_C$  نسبت به  $I$ ،  $90^\circ$  عقب‌تر ترسیم می‌شود. از آنجائیکه مدار

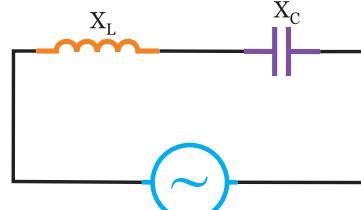
پیش فاز است لذا  $V_L < V_C$  می‌باشد.

اگر  $V_L = V_C$  باشد:

از انجائیکه  $I_L = I_C$  می‌باشد ولتاژ دو سلف و خازن در

مدار شکل (۵-۷) برابر می‌شود لذا ولتاژ منبع صفر خواهد شد

که مدار در حالت تشدید یا رزنانس می‌باشد.



شکل (۵-۷)

$$X_L = X_C \Rightarrow V_L = V_C$$

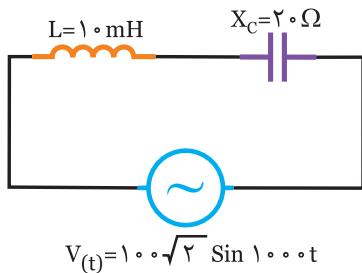
$$V_e = |V_L - V_C| \Rightarrow V = 0$$

$$X_C = X_L \Rightarrow \frac{1}{2\pi f C} = 2\pi f L \Rightarrow (2\pi)^2 f^2 L C = 1 \Rightarrow$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

### مثال ۱

در مدار شکل (۵-۱۳) امپدانس مدار را بدست آورید.



شکل (۵-۱۳)

ابتدا  $X_L$  را بدست می‌آوریم:

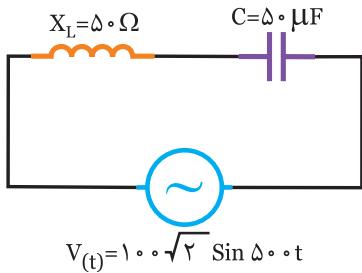
$$X_L = \omega L = 1000 \times 10 \times 10^{-3} = 10 \Omega$$

$$Z = |X_L - X_C| = |10 - 20| = 10 \Omega$$

توضیح: چون  $X_C > X_L$  می‌باشد لذا مدار پیش فاز است.

### نتایج ۱

در مدار شکل (۵-۱۴) امپدانس مدار را بدست آورید.



شکل (۵-۱۴)

ابتدا  $X_C$  را بدست می‌آوریم:

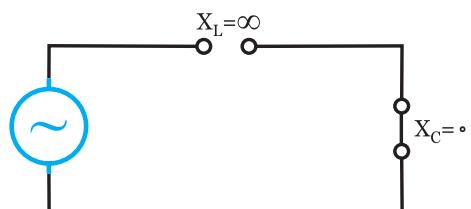
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000 \times 50 \times 10^{-6}} = 20 \Omega$$

$$Z = |X_L - .....| = |50 - .....| = ..... \Omega$$

خازن مدار را قطع می‌کند.

(۲) فرکانس بی‌نهایت:

سلف مدار را قطع می‌کند.



شکل (۵-۱۰)

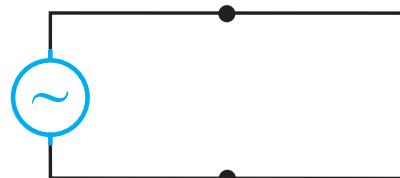
$$X_L = \infty$$

$$X_C = 0$$

$$Z = \infty$$

$$I = 0$$

(۳) فرکانس رزنانس (تشدید):



شکل (۵-۱۱)

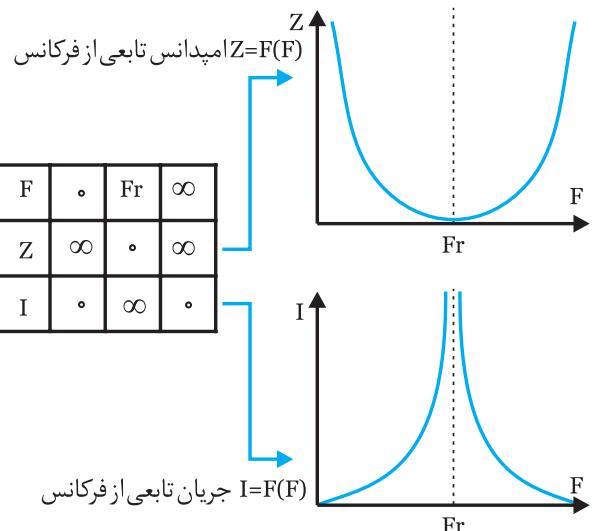
$$X_C = X_L \Rightarrow Z = 0$$

$$V_e = V_L \Rightarrow I = \infty$$

$$P_d = 0$$

$$P_s = 0$$

نتایج بررسی شده را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد.



امپدانس تابعی از فرکانس است.

جریان تابعی از فرکانس است.



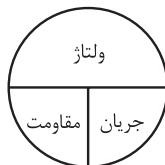
الف) ابتدا مقدار  $X_L$  و  $X_C$  را بدست می‌آوریم.

$$X_L = \omega L = 1000 \times 30 \times 10^{-3} = 30 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000 \times 50 \times 10^{-6}} = 20 \Omega$$

$$Z = |X_L - X_C| = |30 - 20| = 10 \Omega$$

$$\text{ ولتاژ } = \frac{\text{ ولتاژ}}{\text{ مقاومت}} = \text{ جریان}$$

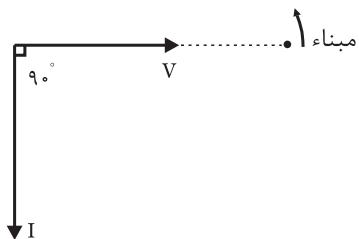


$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100V$$

جریان موثر مدار

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{100}{10} = 10 A$$

- ب) برای نوشتن معادله زمانی جریان نیاز به دیاگرام برداری می‌باشد که به صورت زیر عمل می‌نماییم.
- مبدا را ترسیم می‌کنیم.
  - بردار  $V_{(t)}$  را رسم کنید.



شکل (۵-۱۷)

- در این مدار  $X_L > X_C$  است لذا مدار پس فاز و جریان منبع ۹۰° از ولتاژ مدار عقبتر است و آن را رسم کنید.
- با توجه به موقعیت بردار  $I$  معادله زمانی آن را

$$I_m = I_e \times \sqrt{2} \Rightarrow I_m = 10\sqrt{2} A$$

می‌نویسیم.

$$i_{(t)} = I_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$\Rightarrow i_{(t)} = 10\sqrt{2} \sin(1000t - 90^\circ)$$

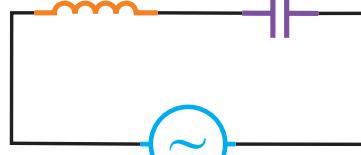
توضیح: چون  $X_L > X_C$  می‌باشد لذا مدار فاز است.



در مدار شکل (۵-۱۵) امپدانس مدار را بدست آورید.

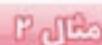
$$L = 50 \text{ mH}$$

$$C = 20 \mu F$$



$$V_{(t)} = 50 \sin 1000t$$

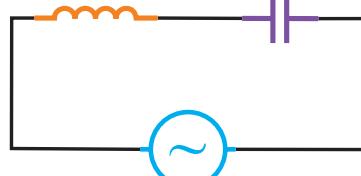
شکل (۵-۱۵)



در مدار شکل (۵-۱۶) مطلوبست:

$$L = 30 \text{ mH}$$

$$C = 50 \mu F$$



$$V_{(t)} = 100\sqrt{2} \sin 1000t$$

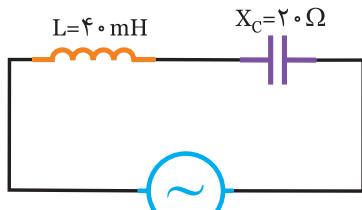
شکل (۵-۱۶)

الف) جریان مدار

ب) معادله زمانی جریان منبع

### تمرین

در مدار شکل (۵-۲۰) مطلوبست:



$$V_{(t)} = 50\sqrt{2} \sin(1000t + 50^\circ)$$

شکل (۵-۲۰)

الف) جریان مدار

ب) معادله زمانی جریان منبع



.....

.....

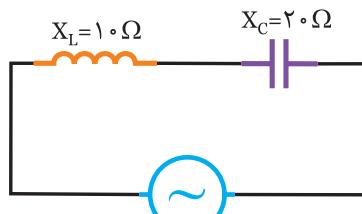
.....

.....

.....

### مثال

در مدار شکل (۵-۲۱) مطلوبست:



$$i_{(t)} = 2\sqrt{2} \sin \omega t$$

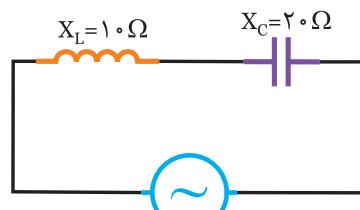
شکل (۵-۲۱)

الف) ولتاژ منبع

ب) معادله زمانی ولتاژ منبع

### فعالیت ۲

در مدار شکل (۵-۱۸) مطلوبست:



$$V_{(t)} = 50\sqrt{2} \sin(500t - 30^\circ)$$

شکل (۵-۱۸)

الف) جریان مدار

ب) معادله زمانی جریان منبع



$$Z = |X_L - X_C| = |..... - .....| = ..... \Omega$$

$$\text{جریان} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$



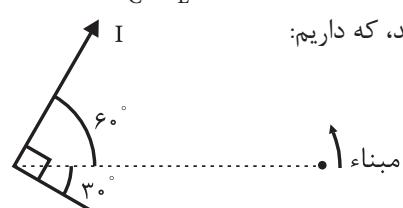
$$V_e = \frac{V}{\sqrt{2}} = \frac{.....}{\sqrt{2}} = ..... V$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} = ..... A$$

ب) برای نوشتن معادله زمانی جریان نیاز به دیاگرام

برداری می‌باشد که در این مدار  $X_C > X_L$  است لذا مدار پیش

فاز می‌باشد، که داریم:



مبناه ۰۱

$$I_m = I_e \times \sqrt{2} = ..... A$$

$$i_{(t)} = I_m \sin(\omega t - 60^\circ) \Rightarrow i_{(t)} = ..... \sin(500t - 60^\circ)$$

شکل (۵-۱۹)



الف)

$$Z = |X_L - X_C| = |10 - 20| = 10\Omega$$

مقاومت  $\times$  جریان = ولتاژ

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} = 2A$$

جریان موثر

$$V_e = Z \cdot I_e = 10 \times 2 = 20V$$

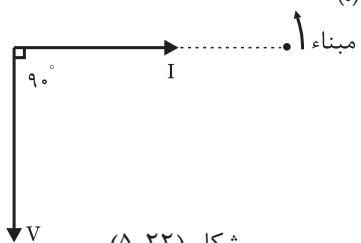
ولتاژ موثر

ب) برای نوشتمن معادله زمانی ولتاژ نیاز به دیاگرام

برداری می‌باشد که به صورت زیر عمل می‌نماییم.

- مبدأ را ترسیم کنید.

- بردار  $i(t)$  را رسم کنید.



شکل (۵-۲۲)

- در این مدار  $X_C > X_L$  است لذا مدار پیش فاز و ولتاژ منبع  $90^\circ$  از جریان مدار عقبتر است و آن را رسم کنید.

- با توجه به موقعیت بردار  $V$  معادله زمانی آن را می‌نویسیم.

$$V_e = \sqrt{2} V_e = \sqrt{2} \times 20 = 20\sqrt{2}V$$

$$V_{(t)} = V_m \sin(\omega t - 90^\circ)$$

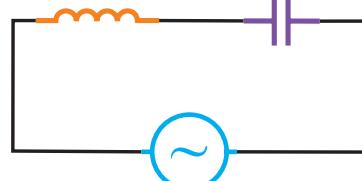
$$\Rightarrow V_{(t)} = 20\sqrt{2} \sin(100\pi t - 90^\circ)$$

### فعالیت ۳

در مدار شکل (۵-۲۳) مطلوبست:

$$L = 4.0 \text{ mH}$$

$$C = 5.0 \mu\text{F}$$



$$i_{(t)} = 3\sqrt{2} \sin(50\pi t + 60^\circ)$$

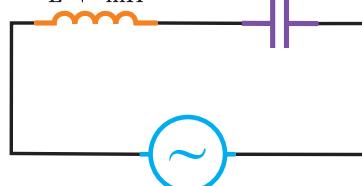
شکل (۵-۲۳)



### فعالیت ۵

در مدار شکل (۵-۲۸) مطلوبست:

$$L=30 \text{ mH} \quad C=50 \mu\text{F}$$



$$i_{(t)} = 5\sqrt{2} \sin(500t - 50^\circ)$$

شکل (۵-۲۸)

الف) ولتاژ دو سر هر المان

ب) معادله زمانی ولتاژ دو سر آنها



الف) ابتدا  $X_L$  و  $X_C$  را بدست می‌آوریم.

$$X_L = \omega L = 500 \times 30 \times 10^{-3} = 15 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{500 \times .....} = ..... \Omega$$

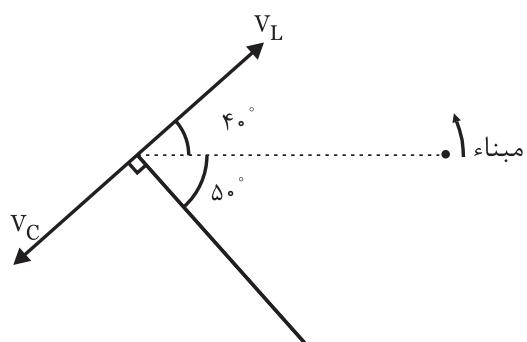
$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{.....}{\sqrt{2}} = ..... A$$

جریان  $\times$  مقاومت = ولتاژ

$$V_L = X_L I_e = (15)(.....) = ..... V$$

$$V_C = X_C I_e = (.....)(.....) = ..... V$$

ب) برای نوشتن معادلات زمانی ولتاژ دو سر سلف و خازن باید مینا را مشخص کرده و دیاگرام معادله زمانی جریان رارسم کنیم و سپس دیاگرام  $V_L$  و  $V_C$  رارسم نماییم.



شکل (۵-۲۹)

$$V_{Lm} = \sqrt{2} \quad V_L = (\sqrt{2})(.....) = ..... V$$

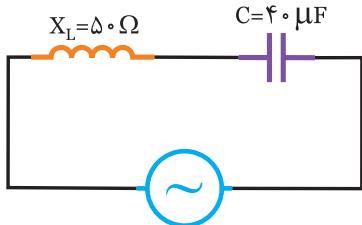
$$V_{Lc} = \sqrt{2} \quad V_c = (\sqrt{2})(.....) = ..... V$$

$$V_{L(t)} = ..... \sin(500t + 40^\circ)$$

$$V_{c(t)} = ..... \sin(500t - 140^\circ)$$



در مدار شکل (۵-۳۰) مطلوبست:



$$i_{(t)} = 4\sqrt{2} \sin(500t + 10^\circ)$$

شکل (۵-۳۰)

الف) ولتاژ دو سر  $V_C$  و  $V_L$

ب) معادله زمانی ولتاژ دو سر هر المان



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

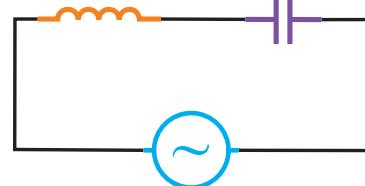
.....



## فعالیت ۵

در مدار شکل (۵-۳۴) مطلوبست:

$$L = ۰/۳ \text{ H} \quad C = ۲۰ \mu\text{F}$$



$$V_{(t)} = ۵۰\sqrt{۲} \sin(۵۰۰t) \text{ V}$$

شکل (۵-۳۴)

(الف) جریان منبع و معادله زمانی آن

(ب) ولتاژ دو سر هر المان

(ج) معادله زمانی ولتاژ آنها



(الف)

$$X_L = \omega L = ۵۰۰ \times ۰/۳ = ..... \Omega$$

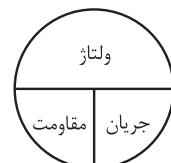
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{.....} = ..... \Omega$$

$$Z = |X_L - X_C| = |150 - .....| = ..... \Omega$$

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{.....}{\sqrt{2}} = ..... \text{ V}$$

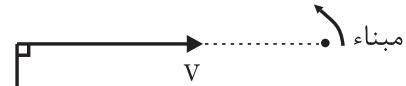
$$\frac{\text{ولتاژ}}{\text{ مقاومت}} = \frac{\text{جریان}}{\text{ مقاومت}}$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{.....}{.....} = ..... \text{ A}$$



برای بدست آوردن معادله زمانی جریان مدار دیاگرام

برداری نیاز می باشد.



شکل (۵-۳۵)

- ابتدا مینا را رسم کنید.
- بردار  $V$  را رسم کنید.
- چون  $X_L > X_C$  است لذا مدار پس فاز است.

$$I_m = \sqrt{۲} I_e = (\sqrt{۲})(.....) = ..... \text{ A}$$

$$I_{(t)} = ..... \sin(۵۰۰t - ۹۰^\circ)$$

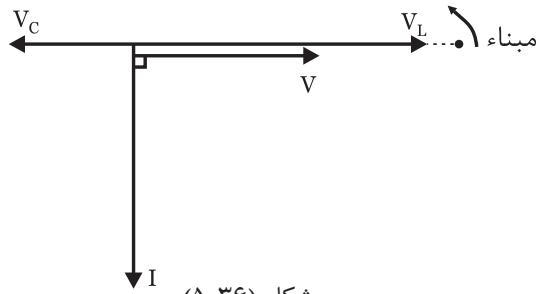
ب) با داشتن جریان مدار، ولتاژ دو سر هر المان را بدست

$$V_L = X_L I_e = ..... \times ..... = ..... \text{ V} \quad \text{آورید.}$$

$$V_C = X_C I_e = ..... \times ..... = ..... \text{ V}$$

ج) برای بدست آوردن معادله زمانی  $V_L$  و  $V_C$  دیاگرام  
برداری نیاز داریم.  
- مینا را مشخص کنید.

- بردار  $V$  و  $I$  را رسم کنید.



شکل (۵-۳۶)  
- ولتاژ سلف  $90^\circ$  از جریان سلف جلوتر است.

- ولتاژ خازن  $90^\circ$  از جریان خازن عقب تر است.

$$V_{Lm} = \sqrt{۲} V_L = (\sqrt{۲})(.....) = ..... \text{ V}$$

$$V_{cm} = \sqrt{۲} V_C = (\sqrt{۲})(.....) = ..... \text{ V}$$

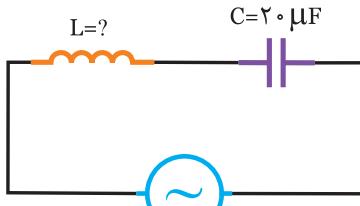
$$V_{L(t)} = ..... \sin(۵۰۰t + ۰)$$

$$V_{c(t)} = ..... \sin(۵۰۰t - ۱۸۰^\circ)$$

مثال ۷

در مدار شکل (۳۸-۵) مطلوبست:

- الف) مقاومت سلفي
  - ب) اندوكتانس سلفي



$$V_{(t)} = 100 \sqrt{2} \sin(\omega_0 t - 30^\circ)$$

$$i_{(t)} = 2\sqrt{2} \sin(\omega_0 t + 60^\circ)$$

شکل (۳۸-۵)



الف) ابتدا ولتاز و جریان موثر مدار را بدست آورید.

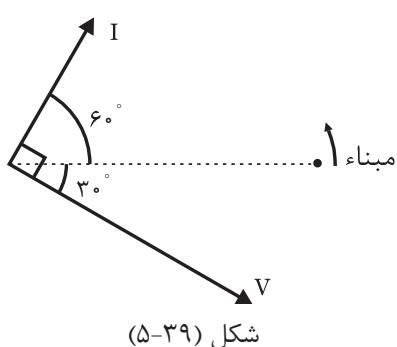
$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100V$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\gamma \sqrt{\gamma}}{\sqrt{2}} = \gamma A$$

ولتاژ جریان مقاومت

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{100}{2} = 50 \Omega$$

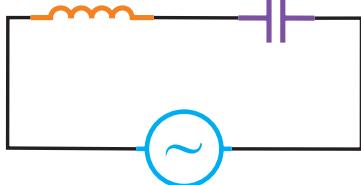
دیاگرام پردازی را ترسیم کنید.



در مدار شکل (۳۷-۵) مطلوب است:

$$L = \Delta \circ m H$$

$$C = \varphi \circ \mu F$$



$$V(t) = \omega_0 \sqrt{2} \sin(\omega_0 t + 90^\circ)$$

شکل (۳۷-۵)

- الف) جریان منبع و معادله زمانی آن  
 ب) ولتاژ دو سر هر المان  
 ج) معادله زمانی  $V_C$  و  $V_I$



دیاگرام برداری را ترسیم کنید.

چون ولتاژ مدار جلوتر از جریان می‌باشد، مدار پس فاز

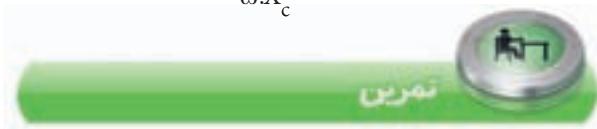
$$Z = |X_L - X_c| \quad \text{و} \quad X_L > X_c \quad \text{است.}$$

$$Z = X_L - X_c \quad X_L = \omega L = 50 \times 10^{-3} \times 1000 = 50 \Omega$$

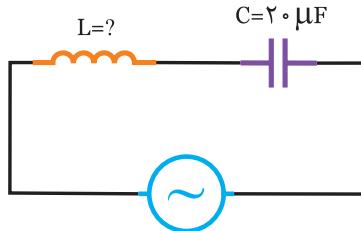
$$\dots = 50 - \dots \Rightarrow X_c = \dots \Omega$$

(ب)

$$X_c = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{1}{50 \times \dots} = \dots \mu F$$



در مدار شکل (۵-۴۱) مطلوبست:



$$V_{(t)} = 100\sqrt{2} \sin(1000t - 50^\circ)$$

$$i_{(t)} = 4\sqrt{2} \sin(1000t + 40^\circ)$$

شکل (۵-۴۱)

الف) مقاومت القابی

ب) ضریب خودالقابی سلف (L)

چون جریان مدار  $90^\circ$  جلوتر از ولتاژ مدار است به همین

دلیل مدار پیش فاز بوده و  $X_c > X_L$  است.

$$Z = |X_L - X_c|$$

$$X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{5000 \times 20 \times 10^{-6}} = 100 \Omega$$

$$Z = X_c - X_L$$

$$50 = 100 - X_L \Rightarrow X_L = 50 \Omega$$

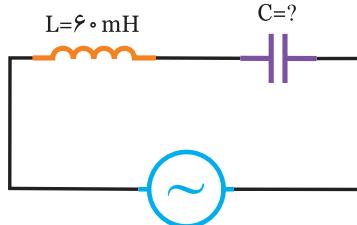
(ب)

$$X_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{50}{5000} = 0.01 H$$

$$L = 100 mH$$

### فعالیت ۷

در مدار شکل (۵-۴۰) مطلوبست:



$$V_{(t)} = 100 \sin 1000t$$

$$i_{(t)} = 5 \sin(1000t - 90^\circ)$$

شکل (۵-۴۰)

الف) مقاومت خازنی

ب) ظرفیت خازن بر حسب میکروفاراد



(الف)

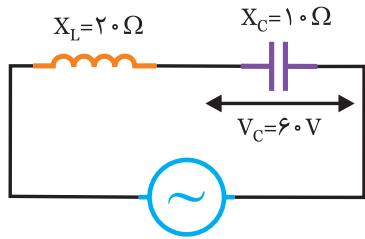
$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = \dots V$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\dots}{\sqrt{2}} = \dots A$$

ولتاژ  
جریان  
 مقاومت

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{\dots}{\dots} = \dots \Omega$$





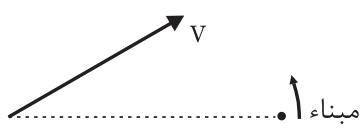
شکل (۵-۴۴)

$$(f) I_e = \frac{V_C}{X_C} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \dots\dots A$$

$$(b) Z = |X_L - X_C| = |\dots\dots - \dots\dots| = \dots\dots \Omega$$

$$V_e = Z \cdot I_e = \dots\dots \times \dots\dots = \dots\dots V$$

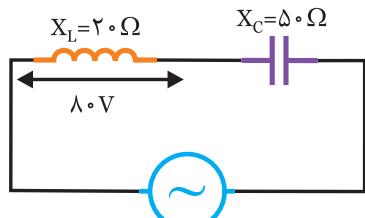
ج) چون  $X_L > X_C$  است، مدار می‌باشد و جریان مدار درجه از ولتاژ مدار است. دیاگرام را کامل کنید.



شکل (۵-۴۵)

### تمرین

در مدار شکل (۵-۴۶) مطلوبست:



شکل (۵-۴۶)

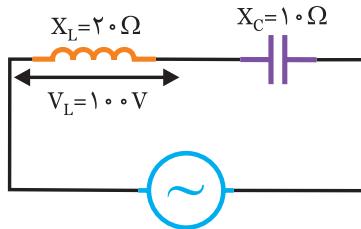
(f) جریان مدار ب) ولتاژ منبع

ج) رسم دیاگرام برداری با فرض  $\theta_V = 0^\circ$



مثال ۷

در مدار شکل (۵-۴۲) مطلوبست:



شکل (۵-۴۲)

(f) جریان منبع

(b) ولتاژ منبع

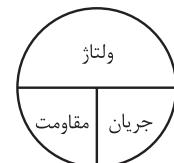
ج) رسم دیاگرام برداری با فرض  $\theta_V = 0^\circ$



(f) حل

$$\frac{\text{ولتاژ}}{\text{مقاومت}} = \frac{\text{جریان}}{\text{مقاومت}}$$

$$I_e = \frac{100}{20} = 5 A$$

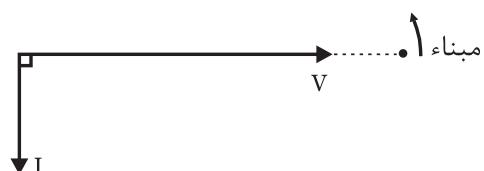


(b)

$$Z = |X_L - X_C| = |20 - 10| = 10 \Omega$$

$$V_e = Z \cdot I_e \Rightarrow V_e = 10 \times 5 = 50 V$$

ج) چون  $X_L > X_C$  است مدار پس فاز می‌باشد و جریان مدار ۹۰° از ولتاژ مدار عقبتر است.



شکل (۵-۴۳)

تعالیت ۷

در مدار شکل (۵-۴۴) مطلوبست:

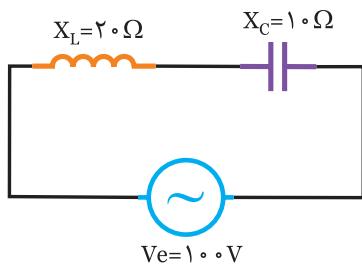
(f) جریان منبع

(b) ولتاژ منبع

ج) رسم دیاگرام برداری با فرض  $\theta_V = 30^\circ$

**مثال ۱**

در مدار شکل (۵-۴۷) مطلوبست:



شکل (۵-۴۷)

الف) توان موثر

ب) توان غیر موثر

ج) توان ظاهري

$P_e = \dots$

(الف)

$$Z = |X_L - X_C| = |\dots - \dots| = \dots \Omega$$

(ب)

$$\text{.....} = \frac{V_e}{\dots} \Rightarrow I_e = \frac{V_e}{\dots} = \frac{\dots}{\dots} = \dots A$$

بخاطر اينكه  $X_C > X_L$  است، توان راكتيو ..... است.

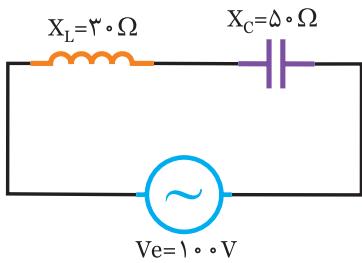
$$P_d = -V_e I_e \sin\phi = -(1)(\dots)(200) = -\dots \text{V.A.R}$$

(ج)

$$P_S = V_e I_e = (\dots)(\dots) = \dots \text{V.A}$$

**تمرین**

در مدار شکل (۵-۴۹) مطلوبست:



شکل (۵-۴۹)

ب) توان غير مفيد مدار

الف) توان اكتيو مدار

ج) توان ظاهري مدار

الف) بخاطر اينكه مقاومت R نداريم توان موثر صفر است.

$$P_e = V_e I_e \cos\phi = 0$$

(ب)

$$Z = |X_L - X_C| = |30 - 50| = 10 \Omega$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{100}{10} = 10 A$$

بخاطر اينكه  $X_C > X_L$  است، توان غير موثر مثبت

$$P_d = V_e I_e \sin\phi = (100)(10)(1) = 1000 \text{V.A.R}$$

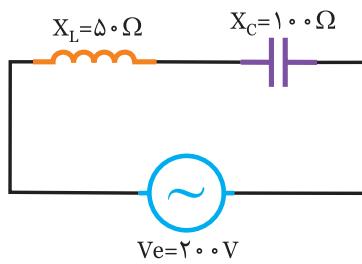
مي باشد.

$$P_S = V_e I_e = 100 \times 10 = 1000 \text{V.A}$$

(ج)

**فعالیت ۱**

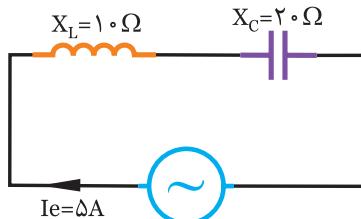
در مدار شکل (۵-۴۸) مطلوبست:



شکل (۵-۴۸)

### مثال ٩

در مدار شکل (٥-٥٠) مطلوبست:



شکل (٥-٥٠)

$$P_e = R I_e^2 = (\dots)(\dots)^2 = \dots \text{W}$$

(الف)

$$P_{dL} = X_L I_e^2 = (4)(\dots)^2 = \dots \text{V.A.R}$$

(ب)

$$P_{dc} = -X_C I_e^2 = -(15)(\dots)^2 = \dots \text{V.A.R}$$

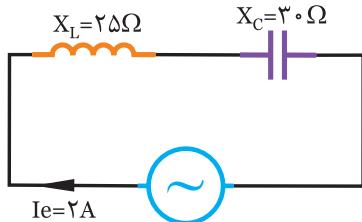
$$P_d = P_{dL} + P_{dc} = \dots - \dots = \dots \text{V.A.R}$$

(ج)

$$P_s = |P_d| = |\dots| = \dots \text{V.A}$$



در مدار شکل (٥-٥٢) مطلوبست:



- شکل (٥-٥٢)
- (الف) توان موثر
  - (ب) توان غیر موثر
  - (ج) توان ظاهري

(الف)

(ب)

(ج)

$$P_e = R I_e^2 = (0)(2)^2 = 0 \text{W}$$

$$P_{dL} = X_L I_e^2 = (10)(2)^2 = 250$$

$$P_{dc} = -X_C I_e^2 = -(20)(2)^2 = -800$$

$$P_d = 250 - 800 = -550 \text{V.A.R}$$

$$Z = |X_L - X_C| = |10 - 20| = 10 \Omega$$

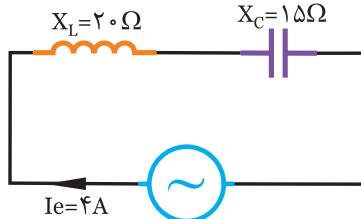
$$P_s = Z I_e^2 = 10(2)^2 = 250 \text{V.A}$$

البته می توان از رابطه  $|P_d| = P_s$  نیز بدست آورید.

$$P_s = |P_d| = |-550| = 550 \text{V.A}$$

### فعالیت ٩

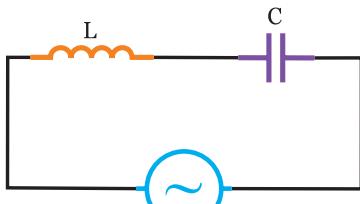
در مدار شکل (٥-٥١) مطلوبست:



شکل (٥-٥١)

### فعالیت ۱

در مدار شکل (۵-۵۴) اگر  $V_c = 2V_L$  باشد. مطلوب است:



$$i_{(t)} = 5\sqrt{2} \sin(1000t + 60^\circ)$$

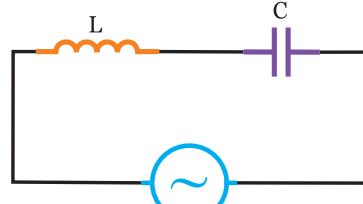
$$V_{(t)} = 200\sqrt{2} \sin(1000t - 30^\circ)$$

شکل (۵-۵۴)

(الف) اندازهی L و C

### مثال ۱

در مدار شکل (۵-۵۳) اگر  $V_L = 3V_C$  باشد. مطلوب است:



$$V_{(t)} = 100\sqrt{2} \sin 500t$$

$$i_{(t)} = 5\sqrt{2} \sin(500t - 90^\circ)$$

شکل (۵-۵۳)

(الف) اندازهی L و C



(الف)

$$V_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \dots\dots V$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \dots\dots A$$

$$V_e = |V_L - V_C| \Rightarrow 200 = 2V_L - V_L \Rightarrow V_L = \dots\dots V$$

$$V_c = 2V_L = 2 \times \dots\dots = \dots\dots V$$

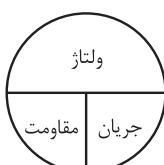
$$\text{ مقاومت} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots}$$

$$X_L = \frac{\dots\dots}{\dots\dots} = \dots\dots \Omega$$

$$X_L = \frac{1}{\dots\dots \times \dots\dots} = \dots\dots \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{\dots\dots}{1000} = \dots\dots mH$$

$$C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{1}{1000 \times \dots\dots} = \dots\dots \mu F$$



$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 V$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5 A$$

$$V_e = |V_L - V_C| \Rightarrow 100 = 3 V_C - V_C \Rightarrow 100 = 2 V_C$$

$$V_C = \frac{100}{2} = 50 V$$

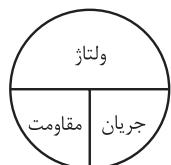
$$V_L = 3 V_C = 3 \times 50 = 150 V$$

$$\text{ ولتاژ} = \frac{\dots\dots}{\text{ مقاومت}} \text{ جریان}$$

$$X_L = \frac{V_L}{I_e} = \frac{150}{2} = 75 \Omega$$

$$X_C = \frac{V_c}{I_e} = \frac{50}{2} = 25 \Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{1}{75 \times 1000} = 1.33 \mu F$$



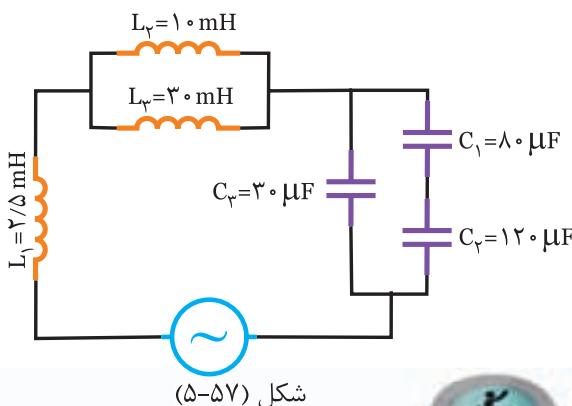
**حل**

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-6}}} =$$

$$= \frac{1000}{2\pi} = 159 \text{ Hz}$$

**فعالیت ۱۱**

فرکانس تشدید مدار شکل (۵-۵۷) را بدست آورید.

**حل**

$$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{120 \times 80}{120 + 80} = \dots\dots\dots \mu F$$

$$C_t = C_1 + C_{eq} = 100 + \dots\dots\dots \mu F$$

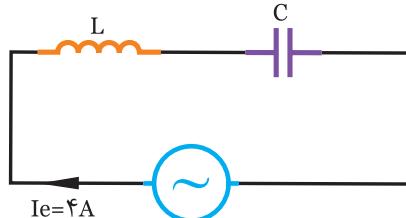
$$L_{eq} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2} = \frac{\dots\dots \times \dots\dots}{\dots\dots\dots} \text{ mH}$$

$$L_t = L_1 + L_{eq} = 2/5 + \dots\dots\dots \text{ mH}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_t C_t}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\dots\dots\dots \times \dots\dots\dots}} \text{ Hz}$$

**تمرین**

در مدار شکل (۵-۵۵) اگر  $V_C = 4V_L$  باشد، مطلوب است: اندازه‌ی  $L$  و  $C$



$$V_e = 100 \text{ V}$$

$$\omega = 1000 \text{ rad/s}$$

شکل (۵-۵۵)

**حل**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

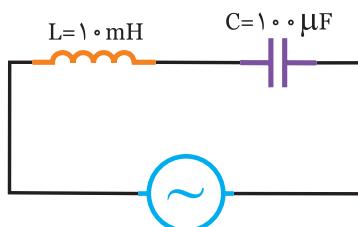
.....

.....

.....

**مثال ۱۱**

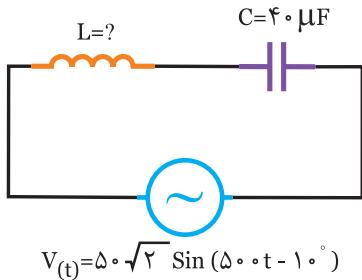
فرکانس رزنانس مدار شکل (۵-۵۶) را بدست آورید.



شکل (۵-۵۶)

### فعالیت ۱۲

در مدار شکل (۵-۶۰) اندوکتانس L را چنان تعیین کنید که مدار در حالت تشدید قرار گیرد.

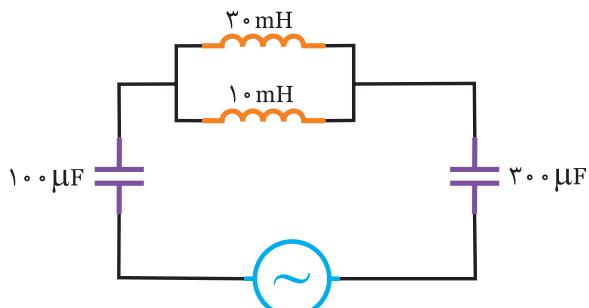


$$V(t) = 50 \sqrt{2} \sin(500t - 10^\circ)$$

شکل (۵-۶۰)

### تمرین

فرکانس رزنانس مدار شکل (۵-۵۸) را بدست آورید.



شکل (۵-۵۸)

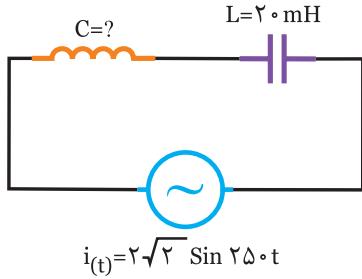


$$X_C = X_L \Rightarrow \frac{1}{\omega C} = \omega L \Rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C}$$

$$L = \frac{1}{(500)^2 \times 1.00 \times 10^{-6}} = \dots\dots\dots \text{mH}$$

### تمرین

در مدار شکل (۵-۶۱) ظرفیت خازن C را چنان تعیین کنید که مدار در حالت تشدید قرار گیرد.

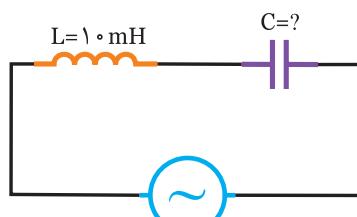


$$i(t) = 2\sqrt{2} \sin 250t$$

شکل (۵-۶۱)

### مثال ۱۲

در مدار شکل (۵-۵۹) ظرفیت خازن C را چنان تعیین کنید که مدار در حالت تشدید قرار گیرد.



$$V(t) = 100 \sin(1000t + 20^\circ)$$

شکل (۵-۵۹)



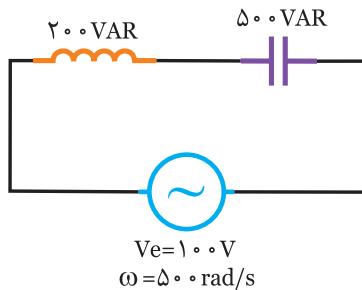
شرط اینکه مدار در حالت رزنانس قرار گیرد است لذا داریم:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{(1000)^2 \times 1.0 \times 10^{-3}} = 100 \mu F$$



### مثال ۱۲

در مدار شکل (۵-۶۵) مطلوبست:



شکل (۵-۶۵)

(الف) اندازهی جریان منبع

(ب) اندازهی  $L$  و  $C$

$$P_d = |P_{dL} - P_{dc}| = \dots - \dots = \dots \text{ V.A.R}$$

$$P_d = V_e I_e \Rightarrow I_e = \frac{P_d}{V_e} = \frac{\dots}{\dots} = \dots \text{ A}$$

$$P_{dL} = X_L I_e^2 \Rightarrow X_L = \frac{P_{dL}}{(I_e)^2} = \frac{\dots}{\dots} = \dots \Omega$$

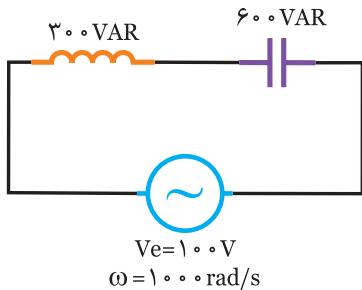
$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{\dots}{\dots} = \dots \text{ mH}$$

$$P_{dc} = X_c I_e^2 \Rightarrow X_c = \frac{P_{dc}}{(I_e)^2} = \frac{\dots}{\dots} = \dots \Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{1}{\dots \times \dots} = \dots \mu\text{F}$$

### تمرین

در مدار شکل (۵-۶۷) مطلوبست:



شکل (۵-۶۷)

(الف) اندازهی جریان منبع

(ب) اندازهی  $L$  و  $C$

### مثال ۱۳

$$P_d = |P_{dc} - P_{dL}| = 500 - 200 = 300 \text{ V.A.R}$$

$$P_d = V_e I_e \Rightarrow I_e = \frac{P_d}{V_e} = \frac{300}{100} = 3 \text{ A}$$

$$P_{dL} = X_L I_e^2 \Rightarrow X_L = \frac{200}{(3)^2} = 22/22 \Omega$$

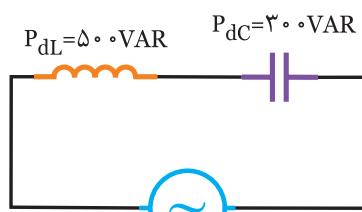
$$P_{dc} = X_c I_e^2 \Rightarrow X_c = \frac{600}{(3)^2} = 66/66 \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{22/22}{500} = 44/44 \text{ mH}$$

$$C = \frac{1}{X_c \omega} = \frac{1}{66/66 \times 500/500} = 36 \mu\text{F}$$

### فعالیت ۱۲

در مدار شکل (۵-۶۶) مطلوبست:



شکل (۵-۶۶)



۱- در مدار LC سری کدام صحیح نیست؟

$P_e = 0$  (۱)

$\text{Cos}\varphi = 0$  (۲)

$\text{Sin}\varphi = 0$  (۳)

$\text{Sin}\varphi = 1$  (۴)

۲- در مدار LC سری در حالت رزنانس کدام صحیح نیست؟

$P_d = 0$  (۱)

$P_s = 0$  (۲)

$P_e = 0$  (۳)

$P_L = P_c$  (۴)

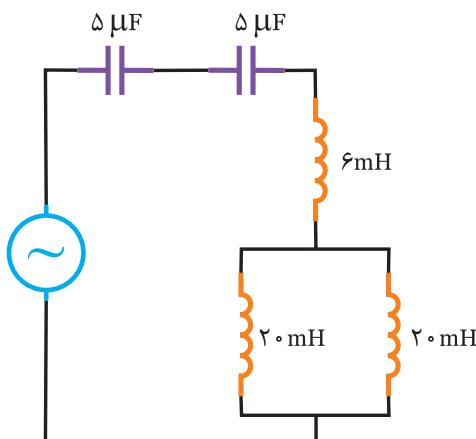
۳- فرکانس تشیدی مدار شکل (۵-۶۸) چند هرتز است.

۱۲۵۰ (۱)

$\frac{125}{\pi}$  (۲)

۱۲۵ (۳)

$\frac{1250}{\pi}$  (۴)



شکل (۵-۶۸)

۴- در مدار LC سری اگر فرکانس زیاد شود  $P_{dL}$  چه خواهد شد؟

(۱) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

(۲) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

(۳) افزایش می‌یابد.

(۴) کاهش می‌یابد.

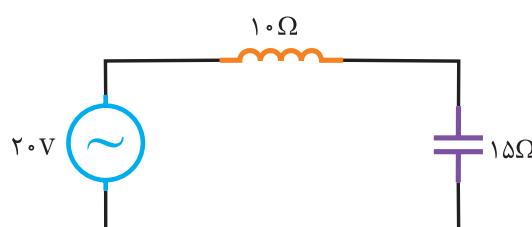
۵- در مدار شکل (۵-۶۹) توان راکتیو چند وار است.

-۲۰ (۱)

۲۰ (۲)

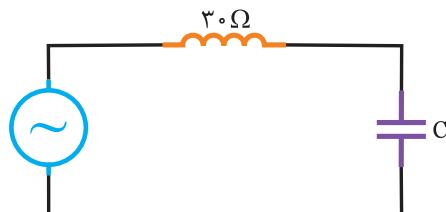
-۸۰ (۳)

۸۰ (۴)

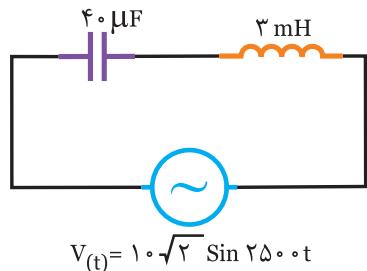


شکل (۵-۶۹)

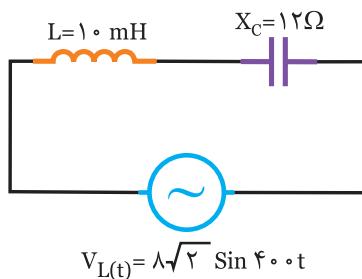
۶- در مدار شکل (۵-۷۰) اگر  $V_{(t)} = 50\sqrt{2} \sin(500t - 90^\circ)$  باشد. ظرفیت خازن چند میکروفاراد است.



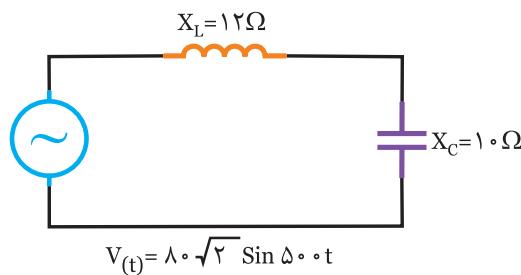
شکل (۵-۷۰)



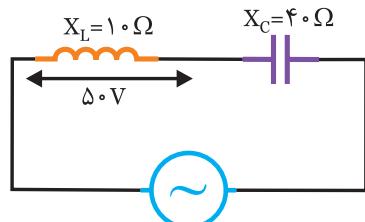
شکل (۵-۷۱)



شکل (۵-۷۲)



شکل (۵-۷۳)



شکل (۵-۷۴)

۷- در مدار شکل (۵-۷۱) مطلوبست:

(الف) جریان مدار

(ب) معادله زمانی جریان مدار

(ج) مدار توسط نرم افزار مولتیسیم به صورت آزمایشگاه مجازی بسته و درستی جوابها را بررسی کنید.

۸- در مدار شکل (۵-۷۲) مطلوبست:

(الف) امپدانس مدار

(ب) معادله زمانی جریان منبع

۹- در مدار شکل (۵-۷۳) مطلوبست:

(الف) معادله زمانی جریان مدار

(ب) معادله زمانی ولتاژ دو سر سلف و خازن

۱۰- در مدار شکل (۵-۷۴) مطلوبست:

(الف) جریان مدار

(ب) ولتاژ منبع

(ج) رسم دیاگرام برداری ولتاژ با فرض  $\theta_v = 50^\circ$

## تحقیق کنید

به کمک موتورهای جستجوگر دربارهٔ لغات زیر مطالعی را تهیه و در کلاس ارائه دهید.

Impedance (۱)

Admittance (۲)

Susceptance (۳)

Reactance (۴)

Serial LC Circuits (۵)

همچنین دربارهٔ تفاوت لغات زیر تحقیق کنید.

Resistance با Resistor (۱)

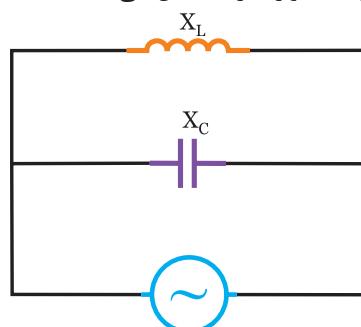
Inductance با Inductor (۲)

Capacitance با Capacitor (۳)

## خلاصه درس

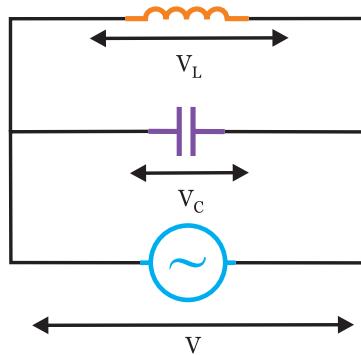
### ۵-۳- مدارهای LC موازی:

هرگاه یک مقاومت سلفی و یک مقاومت خازنی به صورت موازی به یک منبع ولتاژ متناوب متصل شود. مطابق شکل (۵-۷۵) مدار LC موازی را تشکیل می‌دهد.



شکل (۵-۷۵)

در مدارهای LC موازی ولتاژ منبع با ولتاژ هر یک از عناصر که در شکل (۵-۷۶) دیده می‌شود، برابر می‌باشد.



شکل (۵-۷۶)

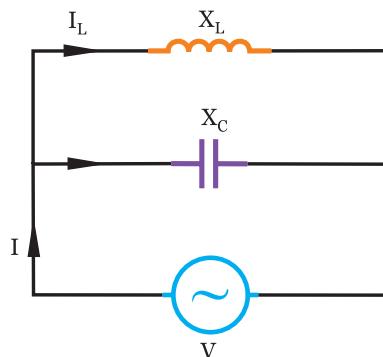
$$\text{جریان} \times \text{ مقاومت} = \text{ولتاژ}$$

$$V = ZI$$

$$V_L = V_C = V_e$$



در این مدارها در شکل (۵-۷۷) جریان منبع به نسبت عکس مقاومتهای سلفی و خازنی تقسیم می‌شود.

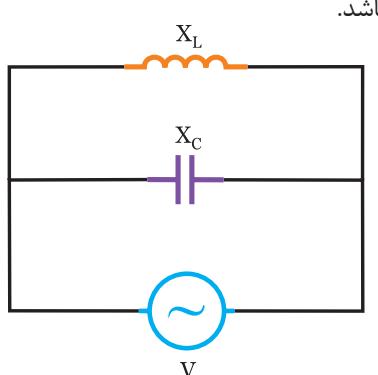


شکل (۵-۷۷)

$$I_e = |I_L - I_C|$$

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} \quad I_C = \frac{V_e}{X_C}$$

در مدارهای LC موازی مطابق شکل (۵-۷۸) اختلاف فاز  $\varphi = 90^\circ$  می‌باشد.



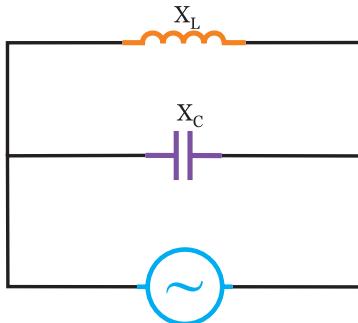
$$V_{(t)} = V_m \sin \omega t$$

$$i_{(t)} = I_m \sin(\omega t \pm 90^\circ)$$

شکل (۵-۷۸)

پس فاز است لذا  $I_L > I_C$  می‌باشد.  
در خازن جریان  $90^\circ$  از ولتاژ دو سرش جلوتر است لذا  $I_C$  نسبت به  $V$   $90^\circ$  جلوتر ترسیم می‌شود از آنجاییکه مدار پس فاز است لذا  $I_L > I_C$  می‌باشد.

**اگر  $X_L > X_C$  باشد:**  
از آنجاییکه  $V_L = V_C$  می‌باشد جریان عبوری از سلف و خازن در مدار شکل (۵-۸۱) برابر می‌شود لذا جریان منبع صفر خواهد شد که مدار در حالت تشديید يا رزنانس می‌باشد.



شکل (۵-۸۱)

$$X_L = X_C \Rightarrow I_c = I_L$$

$$I = |I_L - I_c| \Rightarrow I = 0$$

$$X_L = X_C \Rightarrow \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 2\pi f L \Rightarrow f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

برای بدست آوردن توان در مدارهای LC موازی به علت اینکه  $\varphi = \pm 90^\circ$  است، داریم:

$$\varphi = \pm 90^\circ \Rightarrow \cos \varphi = 0 \quad \sin \varphi = \pm 1$$

- توان موثر یا مصرفی صفر می‌باشد.

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi = 0$$

- توان غیر موثر یا راکتیو می‌شود.

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi = \pm V_e I_e$$

- اگر  $X_L > X_C$  باشد. مدار پيش فاز بوده و  $P_d = -V_e I_e$

می‌شود و اگر  $X_C > X_L$  باشد. مدار پس فاز بوده و  $P_d = V_e I_e$  می‌شود.

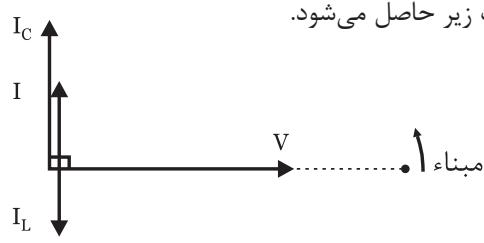
- توان ظاهري می‌شود.

**۵-۴-۴- تاثير فرکانس بر روی امپدانس و جریان در مدار LC موازی:**

از آنجاییکه با افزایش فرکانس مقاومت سلفی  $2\pi f L$  افزایش می‌یابد و با افزایش فرکانس مقاومت خازنی  $\frac{1}{2\pi f C}$

**اگر  $X_L > X_C$  باشد:** مراحل ایجاد نمودار شکل (۵-۷۹) به

صورت زیر حاصل می‌شود.



شکل (۵-۷۹)

- مینما را ترسیم کنید.

- بردار  $V$  را رسم کنید.

- جریان منبع از ولتاژ منبع  $90^\circ$  جلوتر است.

- معادله‌ی زمانی جریان منبع به صورت

$$i_{(t)} = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

نوشته می‌شود.

- در سلف جریان  $90^\circ$  از ولتاژ دو سرش عقب‌تر است لذا

$I_L$  نسبت به  $V$   $90^\circ$  عقب‌تر ترسیم می‌شود.

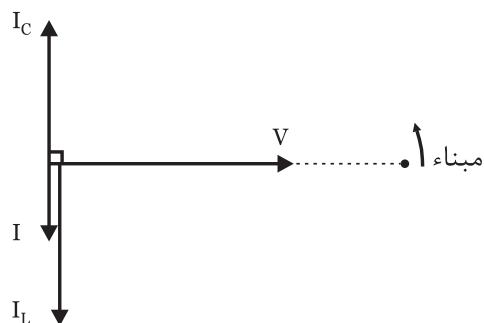
- در خازن جریان  $90^\circ$  از ولتاژ دو سرش جلوتر است لذا

$I_C$  نسبت به  $V$   $90^\circ$  جلوتر ترسیم می‌شود از آنجاییکه مدار

پيش فاز است لذا  $I_C > I_L$  می‌باشد.

**اگر  $X_L < X_C$  باشد:** مراحل ایجاد نمودار شکل (۵-۸۰) به

صورت زیر حاصل می‌شود.



شکل (۵-۸۰)

- مینما را ترسیم کنید.

- بردار  $V$  را رسم کنید.

- جریان منبع از ولتاژ منبع  $90^\circ$  عقب‌تر است.

- معادله‌ی زمانی جریان منبع به

$$i_{(t)} = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$

نوشته می‌شود.

- در سلف جریان  $90^\circ$  از ولتاژ دو سرش عقب‌تر است لذا

$I_C$  نسبت به  $V$   $90^\circ$  عقب‌تر ترسیم می‌شود از آنجاییکه مدار

$$f = f_r \Rightarrow X_L = X_c$$

$$Z = \infty$$

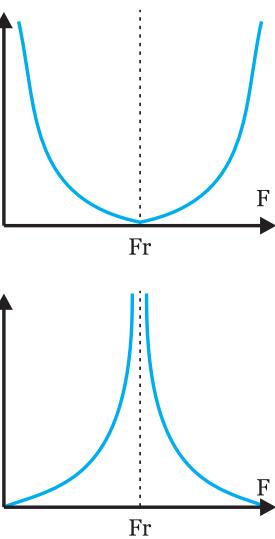
$$I = 0$$

نتایج بررسی شده را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد.

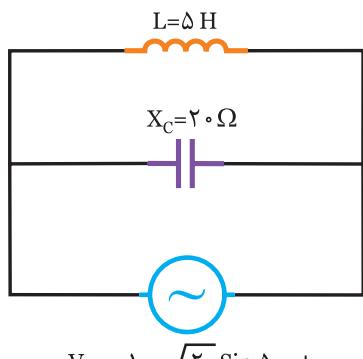
امپدانس تابعی از فرکانس

F	0	Fr	$\infty$
Z	0	$\infty$	0
I	$\infty$	0	$\infty$

جریان تابعی از فرکانس  
(۵-۸۶)



در مدار شکل (۵-۸۴) امپدانس مدار را بدست آورید.



$$V(t) = 100\sqrt{2} \sin 500t$$

شکل (۵-۸۷)

ابتدا  $X_L$  را بدست می‌آوریم.

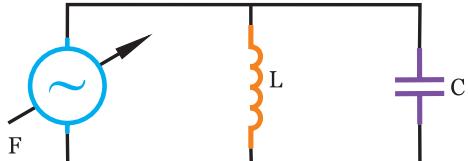
$$X_L = \omega L = 500 \times 0.5 \times 10^{-3} = 2.5 \Omega$$

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_L - X_c|} = \frac{2/0.5 \times 2}{|2/0.5 - 2|} = \frac{2}{1.75} = 1.14 \Omega$$

توضیح: چون  $X_c > X_L$  می‌باشد لذا مدار پس فاز است.

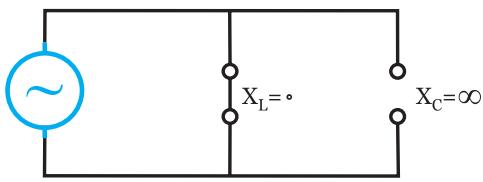
$$\text{کاهش می‌یابد لذا با توجه به فرمول‌های} \\ Z = \frac{1}{\left| \frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_c} \right|}$$

$I = \frac{V}{Z}$  در شکل‌های زیر، Z و I در کمترین و بیشترین فرکانس و فرکانس رزنانس بررسی می‌کنیم.



شکل (۵-۸۲)

۱) فرکانس صفر (DC):



شکل (۵-۸۳)

$$f = 0 \Rightarrow X_L = 0$$

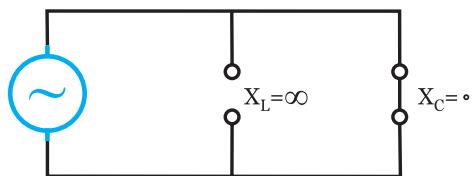
$$X_c = \infty$$

$$Z = \infty$$

$$I = 0$$

سلف مدار را اتصال کوتاه می‌کند.

۲) فرکانس بی‌نهایت:



شکل (۵-۸۴)

$$f = \infty \Rightarrow X_L = \infty$$

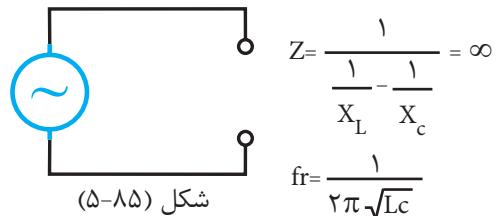
$$X_c = 0$$

$$Z = \infty$$

$$I = 0$$

خازن مدار را اتصال کوتاه می‌کند.

۳) فرکانس رزنانس (تشدید):

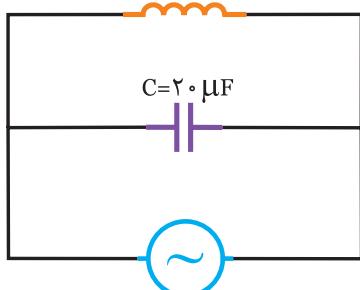


شکل (۵-۸۵)

### مثال ۱۷

در مدار شکل (۵-۹۰) مطلوبست:

$$X_L = 10 \Omega$$



$$V(t) = 50\sqrt{2} \sin 1000t$$

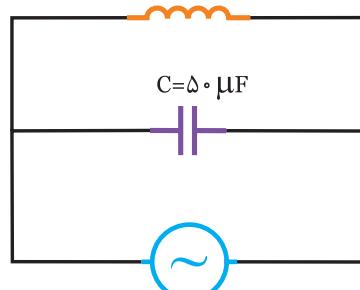
شکل (۵-۹۰)

الف) جریان مدار      ب) معادله زمانی جریان منبع

### فعالیت ۱۵

در مدار شکل (۵-۸۸) امپدانس مدار را بدست آورید.

$$X_L = 10 \Omega$$



$$V(t) = 50 \sin 1000t$$

شکل (۵-۸۸)

### حل

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{..... \times .....} = ..... \Omega$$

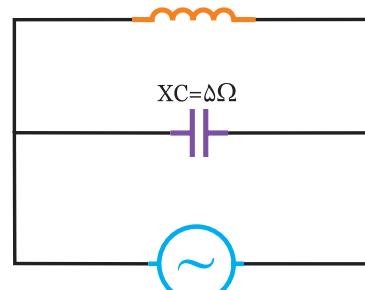
$$Z = \frac{X_C X_L}{|X_C - X_L|} = \frac{..... \times .....}{|..... - .....|} = .....$$

توضیح: چون  $X_L$  می باشد لذا مدار فاز است.

### تمرین

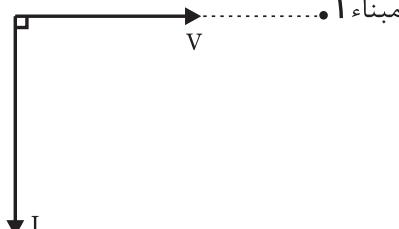
در مدار شکل (۵-۸۹) امپدانس مدار را بدست آورید.

$$XL = 10 \Omega$$



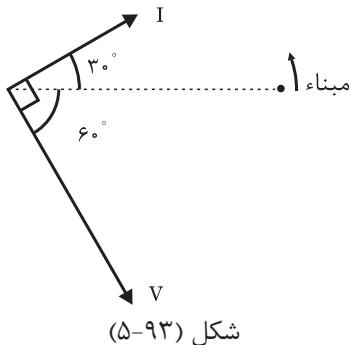
شکل (۵-۸۹)

شکل (۵-۹۱)



$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{\dots}{\dots} = \dots A$$

جریان موثر مدار  
برای نوشتند معادله زمانی جریان نیاز به دیاگرام  
برداری می‌باشد که در این مدار  $X_L > X_C$  است لذا مدار پیش  
فاز می‌باشد، که داریم:



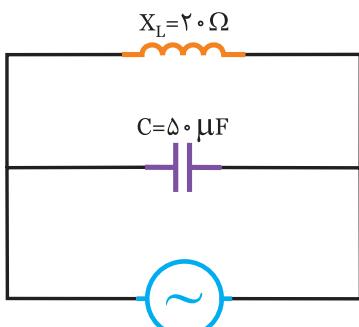
شکل (۵-۹۳)

$$I_m = \sqrt{2} I_e = \dots A$$

$$I_{(t)} = I_m \sin(\omega t + 30^\circ) \Rightarrow I_{(t)} = \dots \sin(\dots + 30^\circ)$$



در مدار شکل (۵-۹۴) مطلوبست:



$$V_{(t)} = 50 \sqrt{2} \sin(500t - 10^\circ)$$

شکل (۵-۹۴)

الف) جریان مدار

ب) معادله زمانی جریان منبع

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

- مینا را ترسیم می‌کنیم.

- بردار  $V_{(t)}$  را رسم کنید.

- در این مدار  $X_L > X_C$  است لذا مدار پس فاز و جریان

منبع  $90^\circ$  از ولتاژ مدار عقبتر است و آن را رسم کنید.

- با توجه به موقعیت بردار I معادله به صورت زیر

می‌شود.

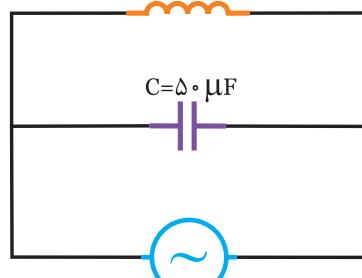
$$I_m = \sqrt{2} I_e = 4\sqrt{2} A$$

$$I_{(t)} = I_m \sin(\omega t + 90^\circ) \Rightarrow I_{(t)} = 4\sqrt{2} \sin(1000t - 90^\circ)$$

### فعالیت ۷

در مدار شکل (۵-۹۲) مطلوبست:

$$L = 100 mH$$



$$V_{(t)} = 100 \sqrt{2} \sin(500t - 60^\circ)$$

شکل (۵-۹۲)

الف) جریان مدار

ب) معادله زمانی جریان منبع



الف)

$$X_L = \omega L = \dots \times 500 = \dots \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{\dots \times \dots} = \dots \Omega$$

$$Z = \frac{X_C X_L}{|X_C - X_L|} = \frac{\dots \times \dots}{|\dots - \dots|} = 200 \Omega$$

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{\dots}{\dots} = \dots V$$

- در این مدار  $X_L > X_C$  است لذا مدار پیش فاز و جریان منبع ۹۰° از جریان مدار عقبتر است و آن را رسم کنید.
- با توجه به موقعیت بردار  $V$  معادله زمانی آن را

$$V_m = \sqrt{2} \quad V_e = \sqrt{2} \times 800 = 800\sqrt{2} \quad \text{می‌نویسیم.}$$

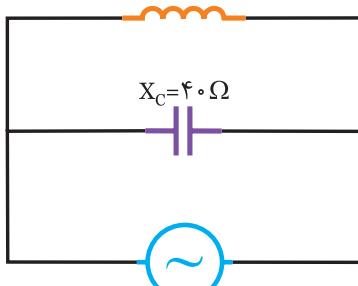
$$V_{(t)} = V_m \sin(500t - 20^\circ)$$

$$\Rightarrow V_{(t)} = 800\sqrt{2} \sin(500t - 20^\circ)$$

### فعالیت ۱۷

در مدار شکل (۵-۹۷) مطلوب است:

$$X_L = 20\Omega$$



$$i_{(t)} = 3\sqrt{2} \sin(\omega t - 40^\circ)$$

شکل (۵-۹۷)

الف) ولتاژ مدار

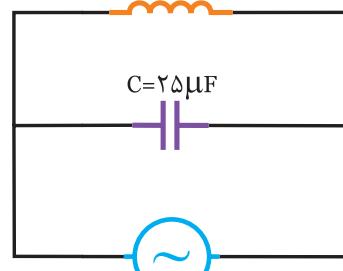
ب) معادله زمانی ولتاژ منبع



### مثال ۱۷

در مدار شکل (۵-۹۵) مطلوب است:

$$X_L = 100\Omega$$



$$i_{(t)} = 2\sqrt{2} \sin(500t + 70^\circ)$$

شکل (۵-۹۵)

الف) ولتاژ منبع

ب) معادله زمانی ولتاژ منبع



الف) ابتدا  $X_c$  را بدست می‌آوریم.

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{500 \times 25 \times 10^{-6}} = 80\Omega$$

$$Z = \frac{X_C X_L}{|X_L - X_C|} = \frac{100 \times 80}{|80 - 100|} = 400\Omega$$

مقاومت  $\times$  جریان = ولتاژ

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2A$$

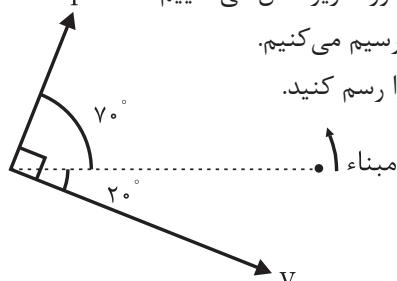
ولتاژ موثر منبع

$$V_e = Z I_e = 400 \times 2 = 800V$$

ب) برای نوشتتن معادله ولتاژ نیاز به دیاگرام برداری

می‌باشد که به صورت زیر عمل می‌نماییم.

- مینا را ترسیم می‌کنیم.
- بردار  $I$  را رسم کنید.



شکل (۵-۹۶)

جریان موثر منبع

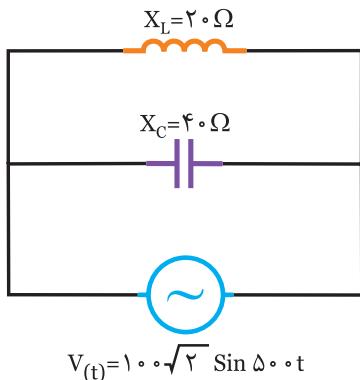
$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\dots\dots\dots}{\sqrt{2}} = \dots\dots\dots A$$

ولتاژ مدار

$$V_e = Z I_e = \dots\dots\dots \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots V$$

## مثال ۱۷

در مدار شکل (۵-۱۰۰) مطلوبست:



شکل (۵-۱۰۰)

- (الف) جریان عبوری از سلف و خازن
- (ب) معادله زمانی جریان سلف و خازن

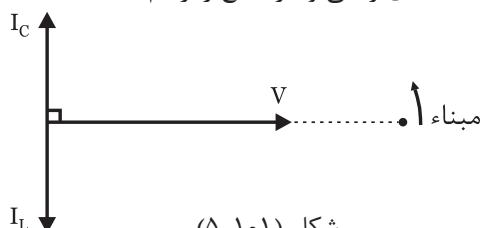
$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100V$$

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{100}{20} = 5A$$

$$I_C = \frac{V_e}{X_C} = \frac{100}{40} = 5/2A$$

- (ب) برای نوشتن معادلات زمانی جریان نیاز به رسم دیاگرام برداری می‌باشد که مرحل آن به صورت زیر است.

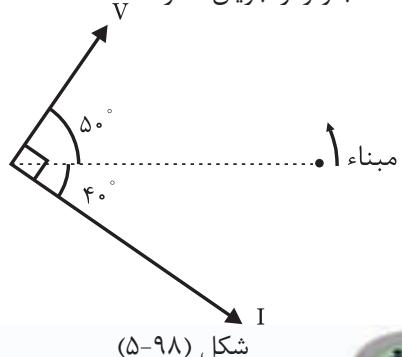
- مبدأ را ترسیم کنید.
- معادله زمانی ولتاژ منبع را رسم کنید.



شکل (۵-۱۰۱)

- در سلف جریان ۹۰° از ولتاژ دو سرش عقبتر است لذا  $I_L$  از ۹۰° از ولتاژ مدار عقبتر است.
- در خازن جریان ۹۰° از ولتاژ دو سرش جلوتر است لذا  $I_C$  از ۹۰° از ولتاژ مدار جلوتر است.

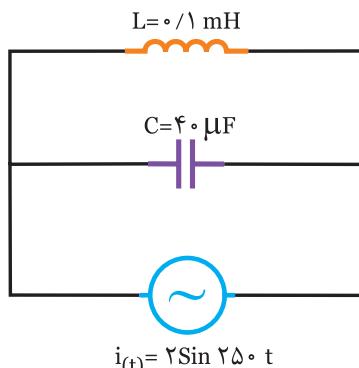
ب) برای نوشتن معادله زمانی ولتاژ منبع نیاز به دیاگرام برداری درایم که در این مدار  $X_C > X_L$  است لذا مدار پس فاز و ولتاژ مدار ۹۰° جلوتر از جریان مدار است.



شکل (۵-۹۸)

## تمرین

در مدار شکل (۵-۹۹) مطلوبست:



شکل (۵-۹۹)

(الف) ولتاژ مدار

(ب) معادله زمانی ولتاژ منبع

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

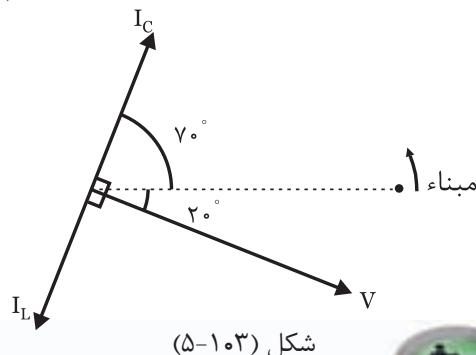
.....

$$I_{Lm} = \sqrt{2} I_L = \dots A$$

$$I_{cm} = \sqrt{2} I_c = \dots A$$

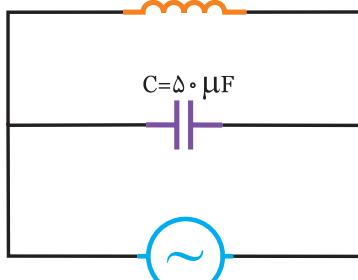
$$I_{L(t)} = \dots \sin(1000t - \dots)$$

$$I_{c(t)} = \dots \sin(1000t + \dots)$$



در مدار شکل (۵-۱۰۴) مطلوبست:

$$X_L = 20 \Omega$$



$$V_{(t)} = 120\sqrt{2} \sin(500t + 30^\circ)$$

شکل (۵-۱۰۴)

(الف) جریان عبوری از سلف و خازن

(ب) معادله زمانی جریان سلف و خازن

- با توجه به موقعیت بردارهای  $I_L$  و  $I_c$  معادله زمانی آنها می‌شود.

$$I_{Lm} = \sqrt{2} I_L = 5\sqrt{2} A$$

$$I_{cm} = \sqrt{2} I_c = 5/2\sqrt{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2} A$$

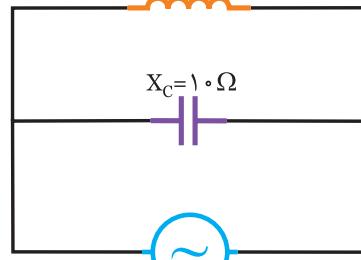
$$i_{L(t)} = 5\sqrt{2} \sin(500t - 90^\circ)$$

$$i_{C(t)} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \sin(500t + 90^\circ)$$

#### فعالیت ۱۶

در مدار شکل (۵-۱۰۲) مطلوبست:

$$L = 20 mH$$



$$V_{(t)} = 50\sqrt{2} \sin(1000t - 20^\circ)$$

شکل (۵-۱۰۲)

(الف) جریان عبوری از سلف و خازن

(ب) معادله زمانی جریان سلف و خازن



(الف)

$$X_L = \omega L = \dots \times \dots = \dots \Omega$$

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{\dots}{\sqrt{2}} = \dots V$$

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{\dots}{\dots} = \dots A$$

$$I_c = \frac{V_e}{X_c} = \frac{\dots}{\dots} = \dots A$$

ب) برای نوشتن معادلات زمانی جریان سلف و خازن باید

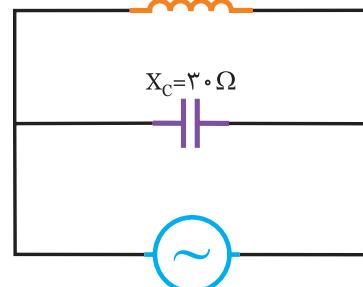
مبنای را مشخص کرده و دیاگرام معادله زمانی ولتاژ را رسم کنیم

و سپس دیاگرام  $I_L$  و  $I_c$  را رسم نماییم.

## مثال ۱۹

در مدار شکل (۵-۱۰۵) مطلوب است:

$$L = 20 \text{ mH}$$



$$i_{(t)} = 2\sqrt{2} \sin(1000t - 90^\circ)$$

شکل (۵-۱۰۵)

الف) ولتاژ منبع و معادلهی زمانی آن

ب) جریان سلف و خازن

ج) معادلهی زمانی جریان سلف و خازن



الف) ابتدا مقاومت سلفی را بدست می‌آوریم.

$$X_L = \omega L = 1000 \times 20 \times 10^{-3} = 20 \Omega$$

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_c - X_L|} = \frac{30 \times 20}{|20 - 30|} = 60 \Omega$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2 \text{ A}$$

$$\text{جریان} \times \text{ مقاومت} = \text{ولتاژ}$$

$$V_e = Z I_e \Rightarrow V_e = 120 = 2 \times 60 \text{ V}$$

برای بدست آوردن معادلهی زمانی ولتاژ دیاگرام برداری

را رسم کنید.

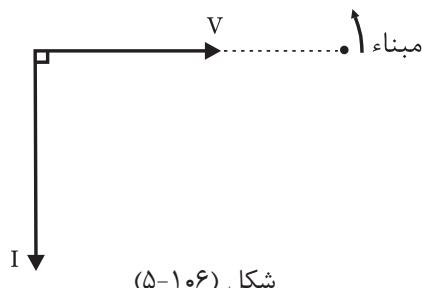
چون  $X_c > X_L$  است مدار خاصیت سلفی دارد و ولتاژ مدار

$90^\circ$  جلوتر از جریان مدار می‌باشد.

ولتاژ ماکزیمم

$$V_m = \sqrt{2} V_e = \sqrt{2} \times 120 = 120\sqrt{2} \text{ A}$$

$$V_{(t)} = V_m \sin \omega t \Rightarrow V_{(t)} = 120\sqrt{2} \sin(1000t)$$



شکل (۵-۱۰۶)

ب) با داشتن ولتاژ مدار، جریان سلف و خازن را بدست

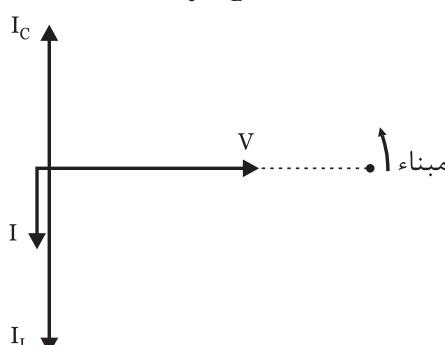
$$\text{ ولتاژ}{\overline{}} = \frac{\text{ جریان}}{\text{ مقاومت}} \quad \text{می‌آوریم.}$$

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{120}{20} = 60 \text{ A}$$



$$I_c = \frac{V_e}{X_c} = \frac{120}{30} = 4 \text{ A}$$

ج) برای بدست آوردن معادلهی زمانی جریان سلف و خازن دیاگرام برداری را ترسیم کرده و با توجه به اینکه جریان سلف  $90^\circ$  عقب‌تر از ولتاژ مدار و جریان خازن  $90^\circ$  جلوتر از ولتاژ مدار می‌باشد معادلهی زمانی  $I_L$  و  $I_c$  را می‌نویسیم.



شکل (۵-۱۰۷)

$$I_{Lm} = \sqrt{2} I_L = 6\sqrt{2} \text{ A}$$

$$I_{cm} = \sqrt{2} I_c = 4\sqrt{2} \text{ A}$$

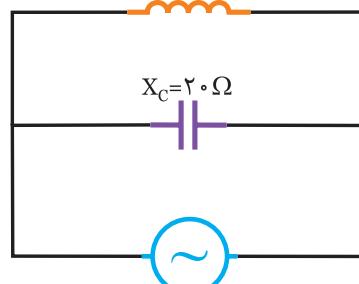
$$i_{L(t)} = 6\sqrt{2} \sin(1000t - 90^\circ)$$

$$i_{c(t)} = 4\sqrt{2} \sin(1000t + 90^\circ)$$

## فعالیت ۱۹

در مدار شکل (۵-۱۰۸) مطلوبست:

$$X_L = 40 \Omega$$



$$i_{(t)} = \sqrt{2} \sin(500t + 30^\circ)$$

شکل (۵-۱۰۸)

الف) ولتاژ منبع و معادلهی زمانی آن

ب) جریان سلف و خازن

ج) معادلهی زمانی جریان سلف و خازن



(الف)

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_L - X_c|} = \frac{\dots \times \dots}{|\dots - \dots|} = \dots \Omega$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\dots}{\dots} = \dots A$$

$$V_e = Z I_e = \dots \times \dots = \dots V$$

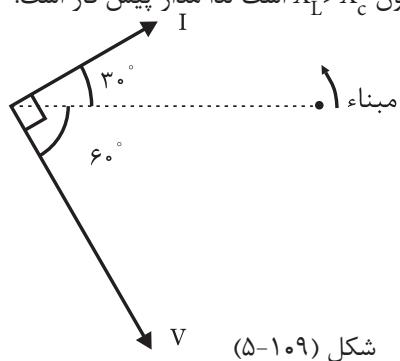
برای بدست آوردن معادلهی زمانی ولتاژ مدار نیاز به

دیاگرام برداری می‌باشد.

- ابتدا منبا را رسم کنید.

- بردار  $i_{(t)}$  را رسم کنید.

- چون  $X_c > X_L$  است لذا مدار پیش فاز است.



شکل (۵-۱۰۹)

$$V_m = \sqrt{2} V_e = \dots \times \dots = \dots V$$

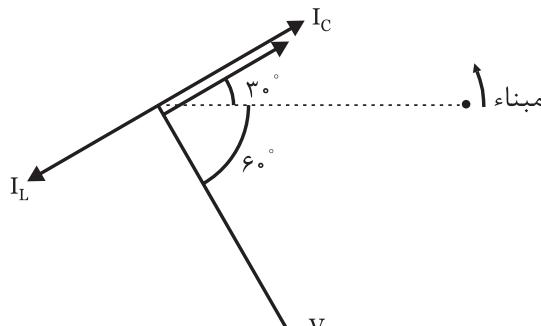
$$V_{(t)} = \dots \sin(500t - \dots)$$

ب) با داشتن ولتاژ مدار، جریان سلف و خازن را بدست آورید.

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{\dots}{\dots} = \dots A$$

$$I_c = \frac{V_e}{X_c} = \frac{\dots}{\dots} = \dots A$$

ج) برای بدست آوردن معادلهی زمانی جریان سلف و خازن دیاگرام برداری را ترسیم می‌نماییم.



شکل (۵-۱۱۰)

$$I_{Lm} = \sqrt{2} I_L = \dots A$$

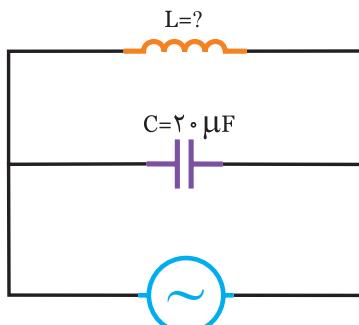
$$I_{cm} = \sqrt{2} I_c = \dots A$$

$$i_{L(t)} = \dots \sin(500t - 150^\circ)$$

$$i_{c(t)} = \dots \sin(500t + \dots)$$

مطالعہ

در مدار شکل (۱۱۲-۵) مطلوبست:



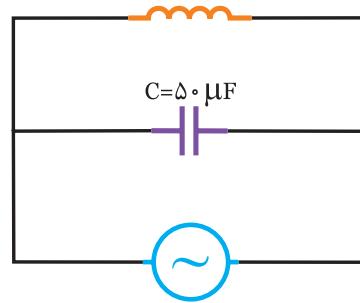
$$V_{(t)} = 100 \sin(\Delta \cdot t + \gamma^\circ)$$

شکل (۱۱۲-۵)

- الف) مقاومت سلفي
  - ب) اندوكتانس سلفي

نمرس

در مدار شکل (۱۱۱-۵) مطلوبست:



$$i(t) = \sqrt{2} \sin(2\pi \cdot t)$$

شكل (١١١-٥)

- الف) ولتاژ منبع و معادلهی زمانی آن
  - ب) جریان سلف و خازن
  - ج) معادلهی زمانی، جریان سلف و خازن

10

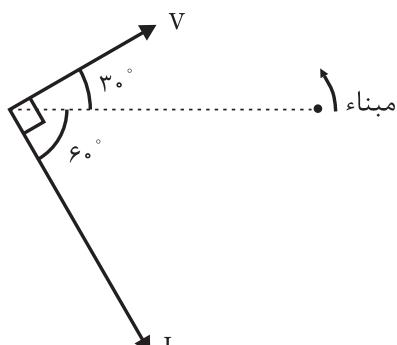
الف)

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2} V$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{\gamma}} = \frac{\gamma}{\sqrt{\gamma}} = \sqrt{\gamma} \text{ A}$$

$$\text{مُقاومَة} = \frac{\text{ولتاژ}}{\text{جريان}} \Rightarrow V_e = \frac{V_o}{I_o} = \frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 50\Omega$$

دیاگرام پر داری را ترسیم کنید.



شكل (١١٣-٥)

حل

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{\dots}{\dots} = \dots A$$

دیاگرام برداری را ترسیم کنید.

چون جریان  $90^\circ$  جلوتر از ولتاژ است به همین دلیل مدار پیش فاز و  $X_L > X_c$  است.

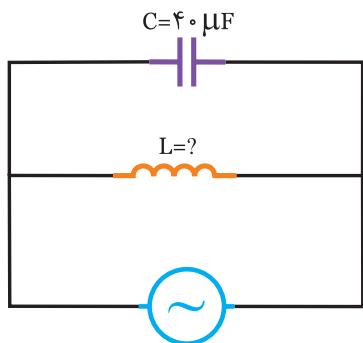
$$X_L = \omega L = \dots \times \dots = \dots \Omega$$

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_L - X_c|} \Rightarrow \dots = \frac{\dots \times X_c}{|\dots - X_c|} \Rightarrow X_c = \dots \Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_c} = \frac{1}{500 \times \dots} = \dots \mu F \quad (b)$$



در مدار شکل (۱۱۵) مطلوبست:



$$V_{(t)} = 100 \sin(500t - 90^\circ)$$

$$i_{(t)} = 4 \sin(500t + 0^\circ)$$

شكل (۱۱۵)

(الف) مقاومت القایی      (ب) ضریب خودالقایی سلف(L)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

چون ولتاژ  $90^\circ$  جلوتر از جریان است به همین دلیل مدار پس فاز و  $X_c > X_L$  است.

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{500 \times 20 \times 10^{-6}} = 100 \Omega$$

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_c - X_L|} \Rightarrow \Delta_0 = \frac{100 X_L}{|100 - X_L|}$$

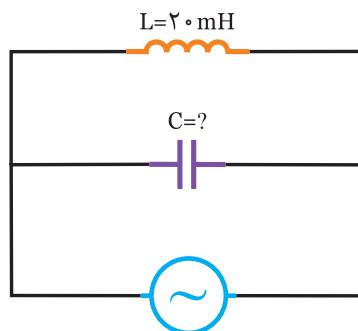
$$\Rightarrow 100 X_L = 5000 - 100 X_L$$

$$\Rightarrow 150 X_L = 5000 \Rightarrow X_L = \frac{5000}{150} = 33.33 \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{33.33}{500} = 66.66 \text{ mH} \quad (b)$$

### فعالیت ۲۰

در مدار شکل (۱۱۴) مطلوبست:



$$V_{(t)} = 120\sqrt{2} \sin(500t - 45^\circ)$$

$$i_{(t)} = 2\sqrt{2} \sin(500t + 45^\circ)$$

شكل (۱۱۴)

(الف) مقاومت خازنی

(ب) ظرفیت خازن



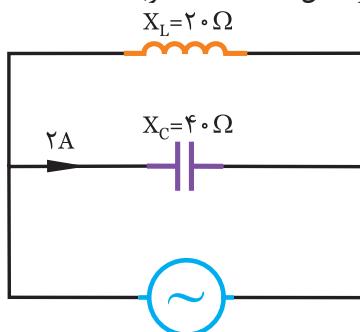
(الف)

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{\dots}{\dots} = \dots V$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\dots}{\dots} = \dots A$$

## فعالیت ۲۱

در مدار شکل (۵-۱۱۸) مطلوبست:



شکل (۵-۱۱۸)

- (الف) ولتاژ منبع
- (ب) جریان منبع
- (ج) رسم دیاگرام برداری با فرض  $\theta_V = 30^\circ$

**حل**

$$V_e = X_c I_c = 40 \times \dots = \dots \text{ V}$$

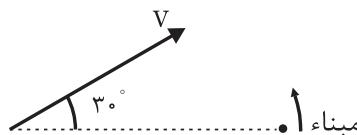
(الف)

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_c - X_L|} = \frac{\dots \times \dots}{|\dots - \dots|} = \dots \Omega$$

(ب)

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{\dots}{\dots} = \dots \text{ A}$$

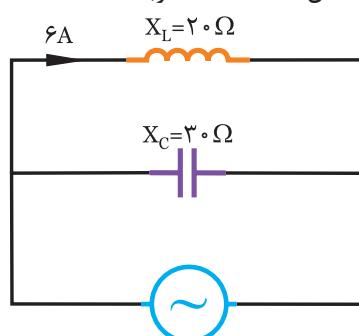
ج) چون  $X_c > X_L$  است مدار فاز می‌باشد و جریان مدار از ولتاژ مدار است.



شکل (۵-۱۱۹)

## مثال ۲۱

در مدار شکل (۵-۱۱۶) مطلوبست:



شکل (۵-۱۱۶)

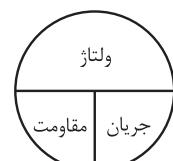
- (الف) ولتاژ منبع
- (ب) جریان منبع
- (ج) رسم دیاگرام برداری با فرض  $\theta_V = 0^\circ$

**حل**

جریان  $\times$  مقاومت = ولتاژ

$$V_e = X_L I_L = 20 \times 6 = 120 \text{ V}$$

(الف)

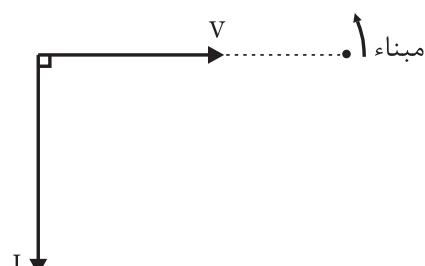


(ب)

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_c - X_L|} = \frac{30 \times 20}{|20 - 30|} = \frac{600}{10} = 60 \Omega$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{120}{60} = 2 \text{ A}$$

ج) چون  $X_c > X_L$  است مدار پس فاز می‌باشد و جریان مدار  $90^\circ$  از ولتاژ مدار عقبتر است.



شکل (۵-۱۱۷)

الف) به خاطر اینکه  $R$  نداریم توان موثر صفر است.

$$P_e = V_e I_e \cos \varphi = 0$$

(ب)

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_c - X_L|} = \frac{20 \times 30}{|20 - 30|} = 60 \Omega$$

$$V_e = Z I_e = 60 \times 2 = 120 \text{ V}$$

به خاطر اینکه  $X_c > X_L$  است توان غیر موثر مثبت است.

$$P_d = V_e I_e \sin \varphi = (120)(2) = 240 \text{ VAR}$$

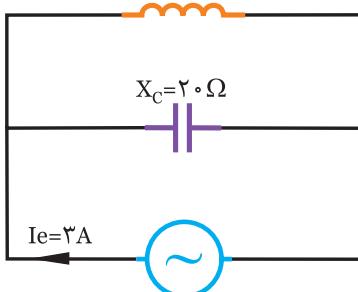
(ج)

$$P_S = V_e I_e = 120 \times 2 = 240 \text{ V.A}$$

### فعالیت ۲۲

در مدار شکل (۵-۱۲۲) مطلوبست:

$$X_L = 25 \Omega$$



شکل (۵-۱۲۲)

الف) توان مفید

ب) توان غیر مفید

ج) توان ظاهری

الف)

(ب)

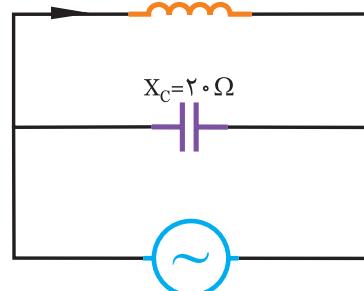
$$P_e = 0$$

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_c - X_L|} = \frac{\dots \times \dots}{|\dots - \dots|} = \dots \Omega$$

$$V_e = Z I_e = \dots \times \dots = \dots \text{ V}$$

در مدار شکل (۵-۱۲۰) مطلوبست:

$$2A \quad X_L = 30 \Omega$$



شکل (۵-۱۲۰)

ب) جریان منبع

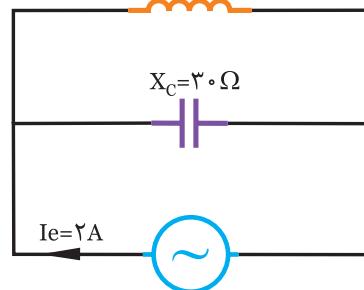
الف) ولتاژ منبع

ج) رسم دیاگرام برداری با فرض  $\theta_v = 0$

### مثال ۲۲

در مدار شکل (۵-۱۲۱) مطلوبست:

$$X_L = 20 \Omega$$



شکل (۵-۱۲۱)

الف) توان موثر

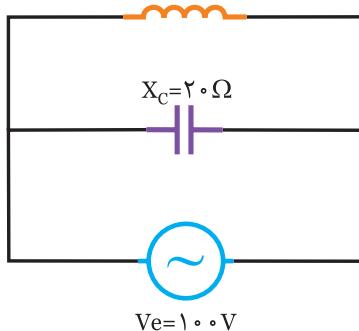
ب) توان غیر موثر

ج) توان ظاهری

## مثال ۲۳

در مدار شکل (۵-۱۲۴) مطلوبست:

$$X_L = 10 \Omega$$



شکل (۵-۱۲۴)

(الف) توان اکتیو

(ب) توان راکتیو

(ج) توان ظاهری

## حل

(الف) چون  $R$  نداریم توان صفر است.

$$P_e = \frac{V_e^2}{R} = \frac{(100)^2}{\infty} = 0 \text{ W}$$

(ب)

$$P_{dL} = \frac{V_e^2}{XL} = \frac{(100)^2}{10} = 1000 \text{ VAR}$$

$$P_{dc} = \frac{V_e^2}{-X_C} = \frac{(100)^2}{-20} = -500 \text{ VAR}$$

$$P_d = P_{dc} + P_{dL} = -500 + 1000 = 500 \text{ VAR}$$

(ج)

$$P_s = |P_d| = 500 \text{ VA}$$

به خاطر اینکه  $X_L > X_C$  است توان غیر موثر است.

$$P_d = -V_e I_e \sin \varphi = -(.....)(.....)(1) = - ..... \text{ V.A.R}$$

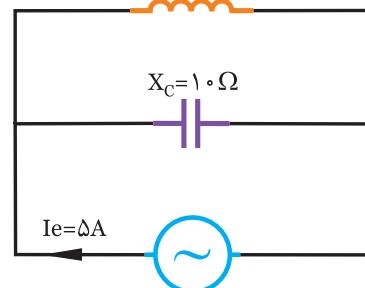
(ج)

$$P_S = V_e I_e = (.....)(.....) = ..... \text{ V.A}$$

## تمرین

در مدار شکل (۵-۱۲۳) مطلوبست:

$$X_L = 5 \Omega$$



شکل (۵-۱۲۳)

(الف) توان مصرفی مدار

(ب) توان غیر مصرفی

(ج) توان ظاهری

## حل

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

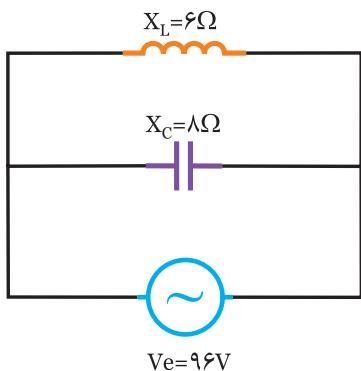
.....

.....

.....

تمرین

در مدار شکل (۵-۱۲۶) مطلوبست:



شکل (۵-۱۲۶)

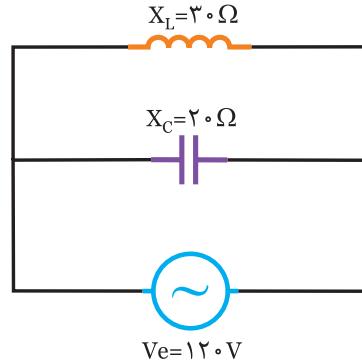
ب) توان غیر موثر

الف) توان موثر

ج) توان ظاهری

فعالیت ۳۳

در مدار شکل (۵-۱۲۵) مطلوبست:



شکل (۵-۱۲۵)

الف) توان واته

ب) توان دواته

ج) توان ظاهری

حل

(الف)

$$P_e = \frac{V_e^2}{R} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots \text{W}$$

(ب)

$$P_{dL} = \frac{V_e^2}{XL} = \frac{(120)^2}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots \text{VAR}$$

$$P_{dc} = \frac{-V_e^2}{Xc} = -\frac{(120)^2}{\dots\dots\dots} = -\dots\dots\dots \text{VAR}$$

$$P_d = P_{dL} + P_{dc} = \dots\dots\dots - \dots\dots\dots = -\dots\dots\dots \text{VAR}$$

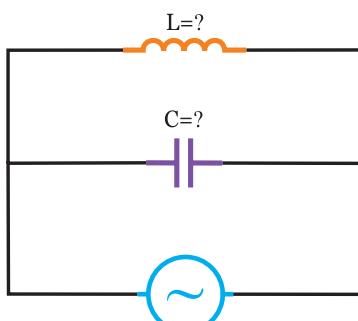
(ج)

$$P_s = |P_d| = |\dots\dots\dots| = \dots\dots\dots \text{V.A}$$

مثال ۲۲

در مدار شکل (۵-۱۲۷) اگر  $I_L = 3I_c$  باشد، مطلوبست:

اندازه‌ی  $C$  و  $L$



$$V(t) = 60\sqrt{2} \sin 500t$$

$$i(t) = 2\sqrt{2} \sin(500t - 90^\circ)$$

شکل (۵-۱۲۷)



$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 30V$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1A$$

$$I_e = |I_c - I_L| \Rightarrow 1 = 2I_L - I_L \Rightarrow I_L = 1A$$

$$I_c = 2I_L = 2(1) = 2A$$

$$I_c = 2I_L = 2(1) = 2A$$

$$X_L = \frac{V_e}{I_L} = \frac{30}{1} = 30\Omega$$

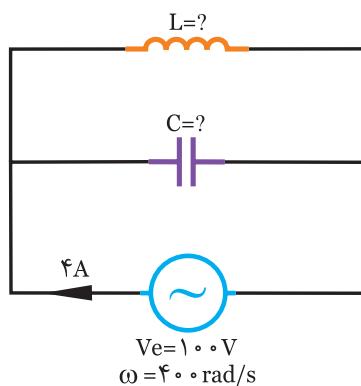
$$X_c = \frac{V_e}{I_c} = \frac{30}{2} = 15\Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{30}{2\pi \times 50} = 0.095mH$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 15} = 0.0001F = 100\mu F$$



در مدار شکل (۵-۱۲۹) اگر  $I_L = 4I_c$  باشد، مطلوبست:  
اندازهی L و C



شکل (۵-۱۲۹)



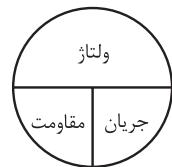
$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{60\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 60V$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2A$$

$$I_e = |I_L - I_C| \Rightarrow 2 = 2I_C - I_C \Rightarrow 2 = I_C \Rightarrow I_C = 2A$$

$$I_L = 2I_C \Rightarrow I_L = 4A$$

$$\text{متناه} = \frac{\text{مقاومت}}{\text{جریان}}$$



$$X_L = \frac{V_e}{I_L} = \frac{60}{2} = 30\Omega$$

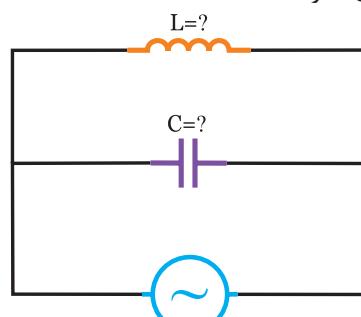
$$X_C = \frac{V_e}{I_c} = \frac{60}{4} = 15\Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{30}{2\pi \times 50} = 0.095mH$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 15} = 0.0001F = 100\mu F$$



در مدار شکل (۵-۱۲۸) اگر  $I_L = 2I_c$  باشد، مطلوبست:  
اندازهی L و C



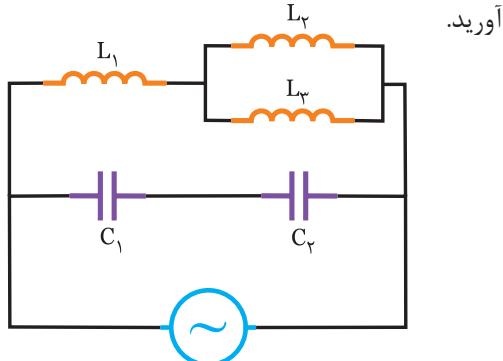
$$V_{(t)} = 30\sqrt{2} \sin(2\pi t - 30^\circ)$$

$$i_{(t)} = \sqrt{2} \sin(2\pi t + 60^\circ)$$

شکل (۵-۱۲۸)

تمرین

در مدار شکل (۵-۱۳۲) فرکانس رزنانس را بدست آورید.



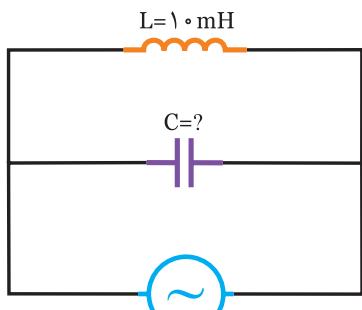
شکل (۵-۱۳۲)

$$L_1 = 6 \text{ mH} \quad L_2 = 12 \text{ mH} \quad L_3 = 6 \text{ mH}$$

$$C_1 = 120 \mu\text{F} \quad C_2 = 240 \mu\text{F}$$

مثال

در مدار شکل (۵-۱۳۳) ظرفیت خازن  $C$  را چنان تعیین کنید که مدار در حالت تشدید قرار گیرد.

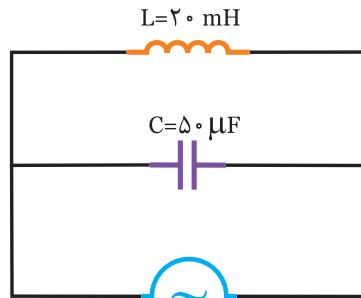


$$\omega = 50 \text{ rad/s}$$

شکل (۵-۱۳۳)

مثال

در مدار شکل (۵-۱۳۰) فرکانس رزنانس را بدست آورید.



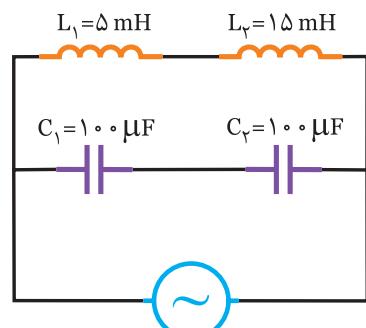
شکل (۵-۱۳۰)

حل

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{Lc}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{20 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-6}}} = 159 \text{ Hz}$$

فعالیت

در مدار شکل (۵-۱۳۱) فرکانس تشدید را بدست آورید.



شکل (۵-۱۳۱)

$$C_t = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\dots \times \dots}{\dots + \dots} = \dots \mu\text{F}$$

$$L_t = L_1 + L_2 = \dots + \dots = \dots \text{ mH}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_t C_t}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\dots \times \dots}} = \dots \text{ Hz}$$



شرط اینکه مدار در حالت تشیدید قرار گیرد این است که باشد لذا داریم.

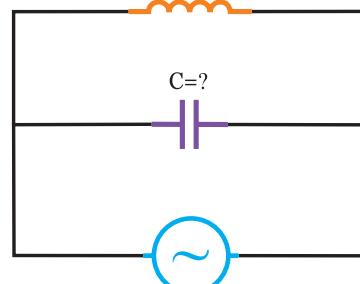
$$X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L}$$

$$C = \frac{1}{(500)^2 (10 \times 10^{-3})} = \frac{1}{250000 \times 10 \times 10^{-3}} = 400 \mu F$$

### فعالیت ۲۷

در مدار شکل (۵-۱۳۴) ظرفیت خازن  $C$  را چنان بیابید که مدار در حالت تشیدید قرار گیرد.

$$L = 5 mH$$

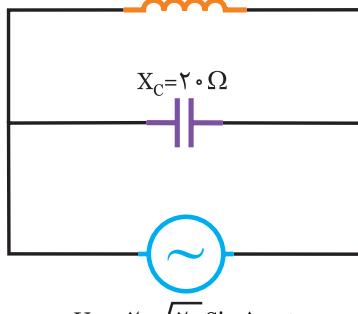


$$V(t) = 100\sqrt{2} \sin(400t + 30^\circ)$$

شکل (۵-۱۳۴)

در مدار شکل (۵-۱۳۶) مطلوبست:

$$X_L = 30 \Omega$$



شکل (۵-۱۳۶)

الف) فرکانس تشیدید

ب) امپدانس مدار در حالت تشیدید

ج) جریان مدار در حالت تشیدید



الف)

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{30}{500} = 60 mH$$

$$C = \frac{1}{X_C \omega} = \frac{1}{20 \times 500} = 100 \mu F$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{60 \times 100 \times 10^{-9}}} = 65 Hz$$



$$X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L}$$

$$C = \frac{1}{..... \times .....} = \frac{1}{.....} = ..... \mu F$$



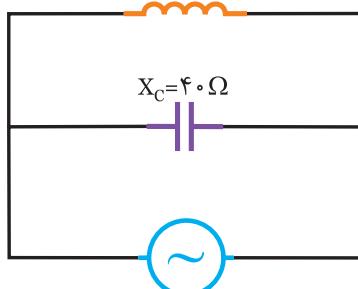
در مدار شکل (۵-۱۳۵) اندوکتانس  $L$  را چنان بیابید که مدار در حالت تشیدید قرار گیرد

.....  
.....  
.....

## تمرین

در مدار شکل (۵-۱۳۸) مطلوبست:

$$X_L = 16\Omega$$



$$V(t) = 5\sqrt{2} \sin(250t + \frac{\pi}{4})$$

شکل (۵-۱۳۸)

الف) فرکانس رزنانس

ب) امپدانس مدار در حالت رزنانس

ج) جریان مدار در حالت رزنانس

ب) از آنجاییکه در رزنانس  $X_c = X_L$  میباشد لذا داریم.

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_c - X_L|} = \frac{X_c X_L}{0} = \infty$$

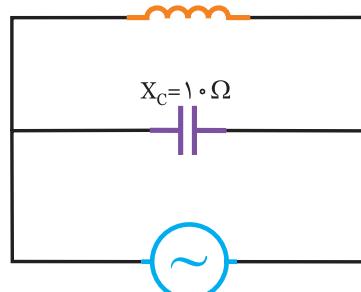
ج)

$$I_e = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\infty} = 0 A$$

## فعالیت ۲۷

در مدار شکل (۵-۱۳۷) مطلوبست:

$$X_L = 2.0\Omega$$



$$\omega = 1000 \text{ rad/s}$$

شکل (۵-۱۳۷)

الف) فرکانس تشدید

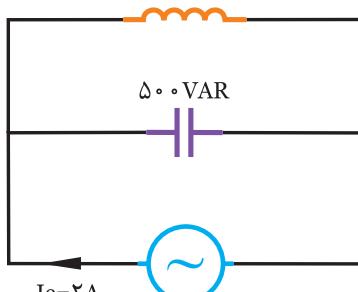
ب) امپدانس در حالت رزنانس

ج) جریان مدار در حالت رزنانس

## مثال ۲۸

در مدار شکل (۵-۱۳۹) مطلوبست:

$$200 \text{ VAR}$$



$$\omega = 50.0 \text{ rad/s}$$

شکل (۵-۱۳۹)

الف) ولتاژ منبع

ب) اندازهی L و C

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{.....}{.....} = ..... \text{ mH}$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{..... \times .....} = ..... \mu F$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{..... \times .....}} = ..... \text{ Hz}$$

ب) چون  $X_c = X_L$  میباشد، داریم.

$$Z = \frac{X_c X_L}{|X_c - X_L|} = \frac{.....}{.....} = ..... \Omega$$

ج)

$$I_e = \frac{V}{Z} = \frac{.....}{.....} = ..... A$$

$$X_L = \frac{V_e^2}{P_{dL}} = \frac{(\dots)^2}{\dots} = \dots \Omega \quad (b)$$

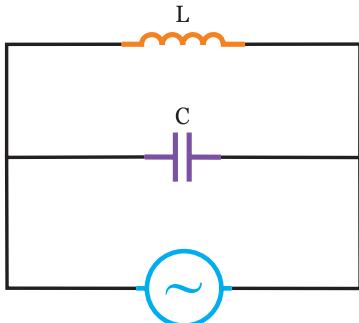
$$X_C = \frac{V_e^2}{P_{dc}} = \frac{(\dots)^2}{\dots} = \dots \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{\dots}{500} = \dots mH$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{\dots \times 500} = \dots \mu F$$



در مدار شکل (۵-۱۴۱) مطلوب است:



شکل (۵-۱۴۱)

(الف) ولتاژ منبع

(ب) اندازهی L و C



$$P_d = |P_{dc} - P_{dL}| = 500 - 200 = 300 \text{ VAR} \quad (f)$$

$$P_e = V_e I_e \Rightarrow V_e = \frac{P_d}{I_e} = \frac{300}{2} = 150 \text{ V}$$

(ب)

$$P_{dL} = \frac{V_e^2}{X_L} \Rightarrow X_L = \frac{V_e^2}{P_{dL}} = \frac{(150)^2}{200} = 112.5 \Omega$$

$$P_{dc} = \frac{V_e^2}{X_C} \Rightarrow X_C = \frac{V_e^2}{P_{dc}} = \frac{(150)^2}{500} = 45 \Omega$$

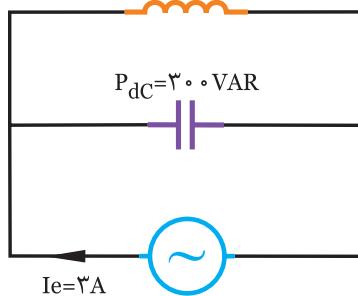
$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{112.5}{500} = 225 \text{ mH}$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{500 \times 45} = 4.44 \mu F$$



در مدار شکل (۵-۱۴۰) مطلوب است:

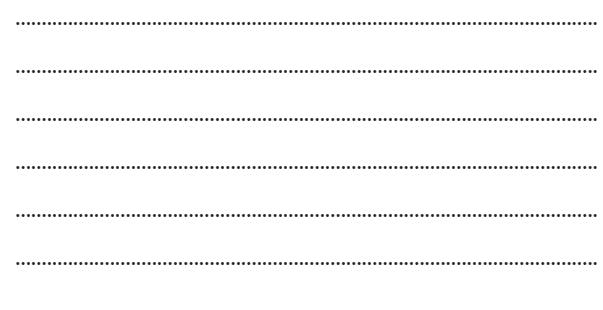
$$P_{dL} = 400 \text{ VAR}$$



شکل (۵-۱۴۰)

(الف) ولتاژ منبع

(ب) اندازهی L و C

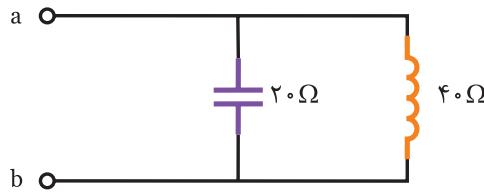


$$P_d = |P_{dL} - P_{dc}| = 400 - 300 = 100 \text{ VAR} \quad (f)$$

$$P_d = V_e I_e \Rightarrow V_e = \frac{P_d}{I_e} = \frac{100}{3} = \dots \text{ V}$$



- مقاومت معادل بین دو نقطه a و b در شکل (۵-۱۴۲) چند اهم است؟



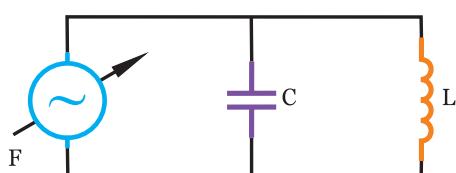
شکل (۵-۱۴۲)

$$X_C = 20 \quad (1)$$

$$X_C = 40 \quad (2)$$

$$X_L = 20 \quad (3)$$

$$X_L = 40 \quad (4)$$



شکل (۵-۱۴۳)

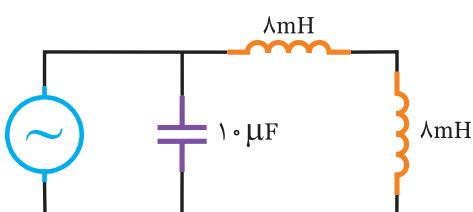
- در مدار شکل (۵-۱۴۳) اگر فرکانس از صفر تا بی‌نهایت افزایش یابد جردن مدار کدام است.

(۱) افزایش می‌یابد.

(۲) کاهش می‌یابد.

(۳) افزایش سپس کاهش می‌یابد.

(۴) کاهش و سپس افزایش می‌یابد.



شکل (۵-۱۴۴)

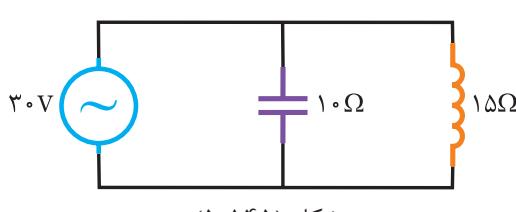
- فرکانس تشذید مدار شکل (۵-۱۴۴) چند هرتز است.

$$\frac{1250}{\pi} \quad (1)$$

$$\frac{125}{\pi} \quad (2)$$

$$1250 \quad (3)$$

$$125 \quad (4)$$



شکل (۵-۱۴۵)

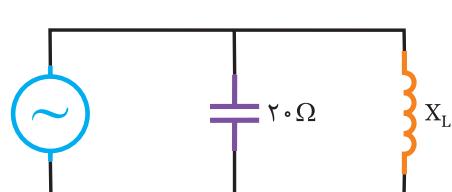
- در مدار شکل (۵-۱۴۵) توان راکتیو چند وار است.

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)



شکل (۵-۱۴۶)

- اگر در شکل (۵-۱۴۶)، باشد راکتانس القایی کدام است.

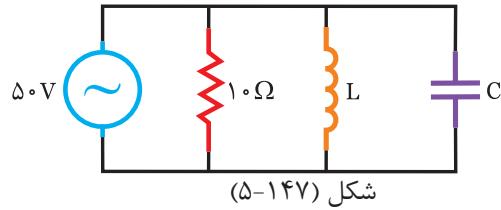
$$20 \quad (1)$$

$$10 \quad (2)$$

$$40 \quad (3)$$

$$5 \quad (4)$$

-۷- اگر جریان مدار شکل (۵-۱۴۷)، ۵A باشد، کدام گزینه صحیح است.



$$X_C = 2X_L \quad (۱)$$

$$X_L = 2X_C \quad (۲)$$

$$X_L = X_C \quad (۳)$$

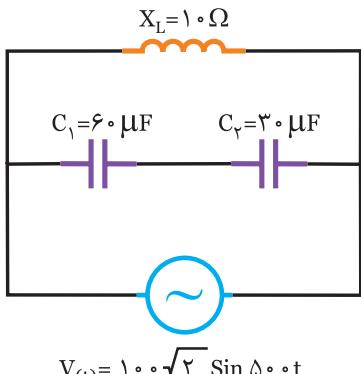
$$L = C \quad (۴)$$

-۸- در مدار شکل (۵-۱۴۸) مطلوبست:

الف) جریان مدار

ب) معادله زمانی جریان منبع

ج) مدار را توسط نرمافزار مولتیسیم بررسی کنید.

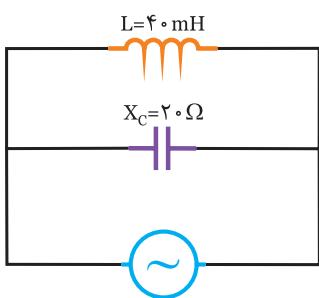


$$V_{(t)} = 100\sqrt{2} \sin 500t$$

-۹- در مدار شکل (۵-۱۴۹) مطلوبست:

الف) ولتاژ منبع

ب) معادله زمانی ولتاژ منبع

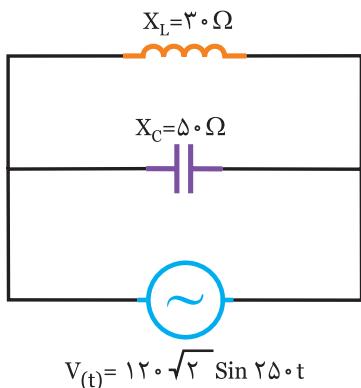


$$i_{(t)} = 2\sqrt{2} \sin (400t + \frac{\pi}{4})$$

-۱۰- در مدار شکل (۵-۱۵۰) مطلوبست:

الف) جریان عبوری از سلف و خازن

ب) معادله زمانی جریان سلف و خازن



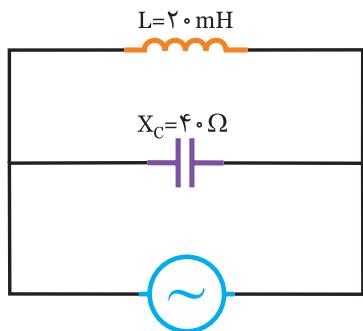
$$V_{(t)} = 120\sqrt{2} \sin 250t$$

۱۱- در مدار شکل (۵-۱۵۱) مطلوبست:

الف) ولتاژ منبع و معادلهی زمانی آن

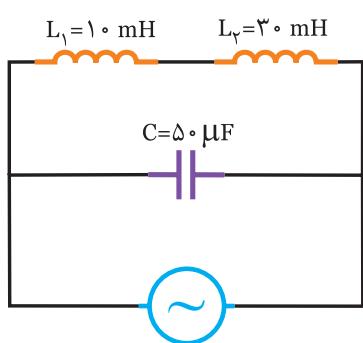
ب) جریان سلف و خازن

ج) معادلهی زمانی جریان سلف و خازن



$$i(t) = 3 \sin(1000t + 30^\circ)$$

شکل (۵-۱۵۱)



شکل (۵-۱۵۲)

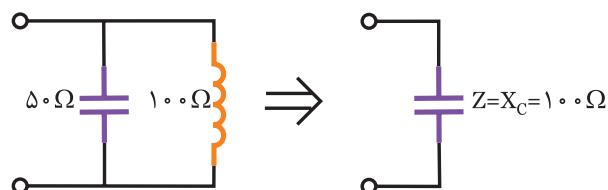
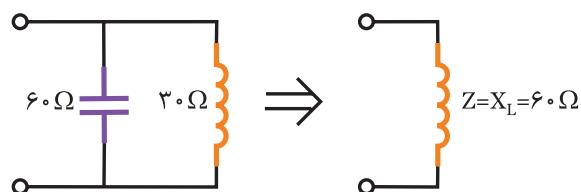
۱۲- در مدار شکل (۵-۱۵۲) فرکانس تشددید را بدست آورید.

**بیشتر بدانید**



اگر در مدار  $LC$  موازی راکتانس خازنی و سلفی یکی دو برابر دیگری باشد امپدانس مدار برابر راکتانس بزرگتر و خاصیت آن

شبیه کوچکتر می‌باشد.



شکل (۵-۱۵۳)

